

**ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»**

Том 23, 1989 год

	Стр.
1. Обзоры	2278
2. Зонная структура и термодинамика полупроводников	2278
3. Примеси и дефекты структуры. Их влияние на свойства полупроводников	2278
3.1. Структура изолированных локальных состояний	2279
3.2. Дислокации и бикристаллы	2281
3.3. Диффузия и растворимость примесей, влияние отжига, взаимодействие примесей и дефектов	2281
3.4. Сильно легированные полупроводники	2282
4. Влияние деформации на зонную структуру и свойства полупроводников	2282
5. Кинетические явления	2283
5.1. Подвижность и механизмы рассеяния	2283
5.2. Гальваномагнитные явления	2284
5.3. Теплопроводность, термоэлектрические и термомангнитные явления	2284
5.4. Кинетические явления в сильном электрическом поле. Горячие электроны	2284
5.5. Кинетика неупорядоченных систем, прыжковый перенос	2285
5.6. Шумы в полупроводниках	2285
6. Распространение звука, акустоэлектрические и фотоакустические явления	2285
7. Распространение электромагнитных волн	2286
8. Резонансные явления в полупроводниках	2286
9. Оптические и магнитооптические явления	2286
9.1. Поглощение, отражение и рассеяние света	2286
9.2. Нелинейная оптика	2287
9.3. Экситоны и электронно-дырочные капли	2287
10. Действие излучений на полупроводник и свойства радиационных дефектов	2287
10.1. Облучение γ -квантами, электронами и позитронами	2288
10.2. Облучение нейтронами и протонами	2288
10.3. Облучение ионами и ионное легирование	2289
10.4. Действие лазерного облучения	2289
11. Явления неустойчивости	2290
11.1. Эффект Ганна	2290
11.2. Ударная ионизация и пробой	2290
12. Неравновесные процессы в полупроводниках	2290
12.1. Фотоэлектрические и фотомагнитные явления. Фотопроводимость и фотоэдс	2291
12.2. Фото- и электролюминесценция, катодолуминесценция	2292
12.3. Рекомбинационно-генерационные процессы. Времена жизни носителей	2293
13. Физика контактных явлений	2293
13.1. Диоды и барьеры Шоттки	2294
13.2. Гетероструктуры	2294
13.3. Варизонные структуры	2294
13.4. Многослойные структуры	2295
13.5. Периодические структуры, сверхрешетки	2295
13.6. МДП структуры	2296
14. Твердые растворы полупроводников	2297
15. Бесщелевые полупроводники и полупроводники с узкой запрещенной зоной	2299
16. Аморфные стеклообразные и жидкие полупроводники	2299
17. Физика двумерных полупроводниковых систем	2300
17.1. Физика поверхности	2300
17.2. Физика пленок инверсионных и эпитаксиальных слоев	2300
18. Применение полупроводников, полупроводниковые приборы	2301
19. Экспериментальные методы	2301
20. Из новых книг, поступивших в Редакцию	2301

1. Обзоры

- Квантовые поправки к проводимости в полупроводниках с двумерным и трехмерным электронным газом. Эксперимент (обзор). Полянская Т. А., Шмарцев Ю. В. 1, 3
- Оптические свойства и электронная структура полупроводников сульфидов и оксидов редкоземельных металлов (обзор). Жузе В. П., Шелых А. И. 3, 393
- Спектроскопия горячей фотолюминесценции в полупроводниках (обзор). Алексеев М. А., Карлик И. Я., Мирлин Д. Н., Сапегга В. Ф. 5, 761
- Магнитная восприимчивость полупроводников в жидком состоянии (обзор). Регель А. Р., Глазов В. М., Кольцов В. Б. 7, 1129

2. Зонная структура и термодинамика полупроводников

- Электронное строение валентной зоны твердых растворов $Al_yGa_{1-y}As$ и $GaAs_{1-x}P_x$ по данным рентгеновской спектроскопии. Терехов В. А., Кашкаров В. М., Домашевская Э. П., Арсентьев Н. Н., Иванова Т. М. 2, 268
- Зонная структура, плотность электронных состояний и оптические свойства $ZnSnSb_2$. Полягалов Ю. И., Басалаев Ю. М., Золотарев М. Л., Поплавной А. С. 2, 279
- Влияние эффективного параметра рассеяния на массу плотности состояний и подвижность в твердых растворах на основе халькогенидов висмута и сурьмы. Кутасов В. А., Лукьянова Л. Н. 4, 652
- Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. I. Теория миграции. Фистуль В. И., Шмугуров В. А. 4, 677
- Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. II. Теория миграции, сравнение с экспериментом. Фистуль В. И., Шмугуров В. А. 4, 684
- Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. III. Теория растворимости. Фистуль В. И., Шмугуров В. А. 4, 688
- Флуктуации дна зоны проводимости в твердых растворах свинец—олово—селен. Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. Е. 4, 742
- Исследование зонной структуры твердых растворов $In_{1-x}Ga_xP$ с использованием фотоэлектрического метода. Крутоголов Ю. К., Довженко С. В., Диордиев С. А., Крутогорова Л. И., Кунакин Ю. И., Рыжих С. А. 5, 887
- Влияние состава на электронную структуру аморфного As_xSe_{1-x} . Шунин Ю. Н., Шварц К. К. 6, 1049
- Зонная структура напряженных (001) сверхрешеток $(InAs)_n(GaAs)_n$. Полягалов Ю. И., Поплавной А. С. 7, 1254
- Обмен-корреляционные взаимодействия и энергетические щели полупроводника.*

Разаренова Л. К., Резник И. М. 7, 39

- Зоны и оптические спектры селенида висмута. Соболев В. В., Крамарь В. М., Козлова С. Г., Темчук Г. И. 8, 1430
- Расчет параметров междолинного рассеяния на фонах в полупроводниковых кристаллах $AlSbV$. Гриняев С. Н., Караваев Г. Ф., Тюттерев В. Г. 8, 1458
- Ширина запрещенной зоны в твердом растворе $GaSb_{1-x}Bi_x$. Гермогенов В. П., Отман Я. И., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 8, 1517
- Анизотропия валентной зоны и стимулированное излучение горячих дырок p -Ge в скрещенных электрическом и магнитном полях. Муравьев А. В., Нефедов И. М., Ноздрин Ю. Н., Шастиа В. Н. 10, 1728
- Энергетический спектр легких и тяжелых дырок в разбавленных магнитных полупроводниках в магнитном поле. Поморцев Р. В., Заблоцкий Е. И. 10, 1796
- Электронная зонная структура монослойных сверхрешеток (111) из узкозонных полупроводников Al^IVB^VI . Канцер В. Г., Малкова Н. М., Тофан В. А. 11, 2006
- k-p*-Параметры полупроводников, рассчитанные методом нелокального эмпирического псевдопотенциала. Белов Н. П., Прокопенко В. Т., Яськов А. Д. 11, 2093
- Немонотонная зависимость ширины запрещенной зоны в пленке бесщелевого полупроводника. Герчиков Л. Г., Субашиев А. В. 12, 2210

3. Примеси и дефекты структуры.

- Их влияние на свойства полупроводников
- Амфотерные свойства германия в $GaAs:Bi$. Чалдышев В. В., Якушева Н. А. 1, 44
- Люминесценция глубоких уровней в n - $GaAs:Ge, Bi$. Чалдышев В. В., Якушева Н. А. 2, 221
- Особенности дефектообразования в эпитаксиальном арсениде галлия, содержащем изовалентную примесь индия. Кольченко Т. И., Ломако В. М., Родионов А. В., Свешников Ю. Н. 4, 626
- Упругие напряжения в Si с электрически пассивными примесями. Мизрухин Л. В., Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К., Яшич В. И. 4, 704
- Проявление донорных свойств примеси скандия в кристаллах $CdTe$ и $ZnTe$. Бабий П. И., Гамерник Р. В., Гнатенко Ю. П., Крочук А. С. 4, 739
- Кинетика изменения концентрации структурных дефектов и их роль в рассеянии дырок в p - $GaSb$. Баранов А. Н., Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Тимченко И. Н., Чугуева З. И., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. 5, 780
- Особенности поведения примеси хрома в теллуриде свинца. Лашкарев Г. В.

* Статьи, отмеченные звездочкой, депонированы в ЦНИИ «Электроника».

- Бродовой А. В., Радченко М. В., Колесник С. П., Вертецкий П. В. 5, 874
- Влияние глубоких уровней на свойства легированного РbТе. Ковалев А. Н., Фоломин П. И., Золотов С. И. 6, 968
- Механизм компенсации в многослойных структурах на основе легированного GaAs, выращенных из раствора-расплава в Ga. Соболев М. М., Брунков П. Н., Конников С. Г., Степанова М. Н., Никитин В. Г., Улин В. П., Долбян А. Ш., Камушадзе Т. Д., Майсурадзе Р. М. 6, 1058
- Дефектные полупроводники Ga_2S_3 и Ga_2Se_3 , легированные железом. Аскеров И. М., Асланов Г. К., Насреддинов Ф. С., Тагиев Б. Г. 6, 1083
- Влияние примеси бора на дрейф вакансий в областях пространственного заряда диодов Шоттки Al-p-Si. Болотов В. В., Стучинский В. А. 7, 1142
- Влияние легирования индием на люминесценцию монокристаллов арсенида галлия. Анастасьева Н. А., Большеева Ю. Н., Освенский В. Б., Степанова И. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 7, 1259
- Пассивация акцепторных центров в фосфиде индия атомарным водородом. Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Шепекина Г. В. 7, 1267
- Глубокие центры в монокристаллах и тонких слоях антимонида индия. Волков В. В., Падалко А. Г., Белотелов С. В., Божко В. В., Лазарев В. Б. 8, 1400
- О влиянии РЗЭ на свойства объемных монокристаллов InP. Байрамов Б. Х., Захаренков Л. Ф., Ильменков Г. В., Мастеров В. Ф., Топоров В. В. 8, 1496
- Глубокие уровни в n-Si, вводимые при высокотемпературном газовом травлении. Омельяновская Н. М., Итальянцев А. Г., Краснобаев Л. Я., Мордкович В. Н., Астахова Е. Ф. 8, 1503
- Об одном механизме образования квазинепрерывно распределенных по энергии ловушек в кристаллах полупроводников и диэлектриков. Тигиняну И. М. 9, 1568
- Влияние легирования расплава-раствора гадолинием и алюминием на электрические и люминесцентные свойства эпитаксиальных слоев GaSb. Виноградова Г. И., Гоголадзе Д. Т., Лошинский А. М., Соловьева Е. В., Долгинов Л. М. 9, 1651
- Энергетические уровни в $CuInS_2$, связанные с собственными дефектами. Аксенов И. А., Корзун Б. В., Маковецкая Л. А., Соболев Н. А., Жуков С. П. 9, 1696
- Легирование слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As$ самарием. Воробьева В. В., Егорова М. В., Крещук А. М., Новиков С. В., Савельев И. Г. 9, 1699
- Пассивация доноров и акцепторов в тройных и четверных растворах системы InGaAsP с помощью атомарного водорода. Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Шепекина Г. В. 9, 1711
- Влияние отношения потоков мышьяка и галлия на люминесценцию арсенида галлия, полученного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Лубышев Д. И., Мигаль В. П., Преображенский В. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 10, 1913
- Нейтрализация мелких примесей в крениии светом из области фундаментального поглощения. Берман Л. В., Селверстов А. И. 11, 1959
- ### 3.1. Структура изолированных локальных состояний
- Нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней в твердых растворах: донорный уровень в $GaAs_{1-x}P_x$. Зубков В. И., Пихтин А. И., Соломонов А. В. 1, 64
- Влияние случайных полей на спектр ЭПР акцепторов Mn_{Ga} в p-GaAs. Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Красикова О. Г., Осипов Е. В., Рещиков М. А. 1, 73
- Примесные состояния галлия в сульфиде свинца по данным ИК поглощения. Вейс А. Н., Круницкая Р. Ю. 1, 185
- Конфигурационные перестройки бистабильных центров в ковалентных полупроводниках — фазовые переходы второго рода. Иванович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. 2, 264
- Допустимые значения параметров уровня собственных дефектов в твердых растворах свинец-олово-селен. Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. Е. 2, 328
- Неэквивалентные состояния примеси фосфора в кристаллах CdTe. Агринская Н. В., Матвеев О. А., Терентьев А. И., Шашкова В. В. 3, 439
- О конфигурации «аномального» мюниона в кристаллической решетке кремния. Гордеев В. А., Гуцев Г. Л., Мякенькая Г. С. 3, 493
- Реакции центров золота с отрицательной корреляционной энергией в твердых растворах Si-Ge. Атабаев И. Г., Баграев Н. Т., Машков В. А., Саидов М. С., Сирожов У., Юсупов А. 3, 525
- О возможной природе остаточных глубоких центров в фосфиде индия. Кольченко Т. И., Мороз С. Е. 3, 546
- Исследование радиационных дефектов в р-кремнии с помощью лития.* Баринаева Э. Ю., Берман Л. С., Грехов И. В., Григорьева Г. М., Каган М. Б., Кушашвили К. Ш. 3, 582
- Сравнение параметров глубоких центров в высокоомных полупроводниках при измерении методом фотозлектрической релаксационной спектроскопии в вариантах температурного и частотного сканирования. Омельяновский Э. М., Поляков А. Я., Тишкин М. В. 4, 725
- Изучение локальных центров в p-GaAs, легированном медью, методами неста-

- пионарной спектроскопии глубоких уровней и фотолуминесценции. Быковский В. Ю., Вовненко В. И., Дмитрук Н. Л. 4, 729
- Кластерный расчет деформационных зарядов дефектов в кремнии. Греков А. М., Кустов В. Е., Трипачко Н. А., Шаховцов В. И. 4, 746
- Спин-поляризованный расчет электронной структуры примесей переходных элементов в полупроводниках. Хром в арсениде и фосфиде галлия. Васильев А. Э., Ильин Н. П., Мастеров В. Ф. 5, 804
- Проводящая зона в условиях структурного беспорядка. Гинзбург Л. П. 5, 813
- Влияние облучения электронами на свойства фосфида индия, легированного 3d-элементами. Саморуков Б. Е., Слободчиков С. В. 5, 924
- Состояние Eu и Mn в теллуриде свинца. Громовой Ю. С., Дарчук С. Д., Коновалов В. Н., Лакеенков В. М., Пляцко С. В., Силов Ф. Ф. 6, 1025
- Об одной особенности донора — серы в GaP. Бирюлин Ю. Ф., Лагвилава Т. А., Милевидский М. Г., Писаревская В. А., Соловьева Е. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 6, 1070
- Оптическая самокомпенсация донорных центров железа в кремнии. Баграев Н. Т., Половцев И. С. 6, 1098
- Энергетический спектр многозарядных примесных центров в кубических полупроводниках. Аверкиев Н. С., Белорусец Е. Д., Имамов Э. З., Ребане Ю. Т. 7, 1193
- Примесь индия в селениде свинца — центр с отрицательной корреляционной энергией. Вейс А. Н., Прокофьева Л. В. 7, 1230
- Позитронная диагностика дефектов в карбиде кремния, облученном нейтронами. Гирка А. И., Кулешин В. А., Мокрушин А. Д., Мохов Е. Н., Свирида С. В., Шишкин А. В. 7, 1270
- Наблюдение примесных состояний в высокоомном арсениде галлия методом фотоотражения. Пхитин А. Н., Айраксинен В.-М., Липсанен Х., Туоми Т. 7, 1280
- Изменение спектра глубоких уровней в $GaAs_{1-x}P_x$ в процессе создания ионно-имплантированных $p-n$ -переходов.* Кольцов Г. И., Ладыгин Е. А., Юрчук С. Ю. 7, 1320
- Энергетический спектр мелких акцепторов в сильно одноосно деформированном Ge. Воеводин Е. И., Гершензон Е. М., Гольдман Г. Н., Птицина Н. Г. 8, 1356
- Туннельная ионизация примесных атомов фосфора в кремнии при температуре 4.2 К. Охонин С. А., Французов А. А. 8, 1362
- Магнитоспектроскопия комплекса D(H₂O) в германии. Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов - Омский В. И., Кропотов Г. И., Халлер Ю. Э. 8, 1440
- Электронная структура собственных дефектов кристаллической решетки PbSe и $Pb_{1-x}Sn_xSe_x$. Бродовой А. В., Лашкарев Г. В., Кучеренко И. В. 8, 1506
- Структура компенсирующих центров в облученном нейтронами α -германии. Ерчак Д. П., Кособуцкий В. С., Стельмах В. Ф. 9, 1539
- Примесные центры диспрозия в аморфном гидрогенизированном кремнии. Регель А. Р., Абдуманапов У. Ж., Васильев В. А., Мездрогина М. М., Насрединов Ф. С., Серегин П. П. 9, 1552
- Локализованные состояния в условиях структурного беспорядка. Гинзбург Л. П. 9, 1629
- Структура пика E3 в арсениде галлия. Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. 9, 1635
- Реакции центров железа, индуцированные пиннигом уровня Ферми в кремнии p -типа. Баграев Н. Т., Половцев И. С. 9, 1643
- Влияние заряженных центров на захват медленных электронов нейтральными примесями в полупроводниках. Гольдгур Е. Б., Рабинович Р. И. 9, 1674
- Бистабильные дефекты в GaAs, выращенном методом жидкофазной эпитаксии. Брунков П. Н., Коныков С. Г., Паленцев М. И., Соболев М. М., Степанова М. Н. 9, 1689
- Влияние анодного окисления на глубокие уровни в арсениде галлия. Тихов С. В., Касаткин А. П., Карпович С. И., Кудрявцева Н. В. 9, 1694
- Емкостная спектроскопия глубоких уровней облученных твердых растворов германий-кремний. Белокурова И. Н., Третьяк О. В., Шаховцова С. И., Шварц М. М., Шматов А. А. 10, 1869
- Магнитоспектроскопия литийсодержащих доноров в германии. Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов - Омский В. И., Кропотов Г. И. 10, 1874
- Определение параметров глубоких центров в перекомпенсированном полупроводнике методом температурной зависимости емкости и активной проводимости. Берман Л. С., Клиггер П. М., Фистуль В. И. 11, 1947
- Зависимость от состава параметров глубокого центра в эпитаксиальных слоях $Pb_{1-x}Sn_xTe<In>$. Засавацкий И. И., Мандонашвили Б. Н., Трофимов В. Т. 11, 2019
- Ag_{Ga} — новый ян-теллеровский акцептор в GaAs. Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Седов В. Е., Цадульников А. Ф. 11, 2072
- Изучение спектра глубоких центров в антимониде индия методом РСГУ. Дружинина Л. В., Молодцова Е. В., Кожухова Е. А., Поляков А. Я., Попков А. Н., Тишкин М. В., Шленский А. Л. 11, 2088
- Резонансные состояния в монокристаллах $PbTe<Ti>$, выращенных методом Чохральского. Тетеркин В. В., Белоконь С. А. 11, 2096

- Энергетический спектр примесей 3d-элементов в CdTe. Кикоин К. А., Курек И. Г., Мельничук С. В. 12, 2453
- Позитронная диагностика вакансионных дефектов в облученном электронами карбиде кремния. Гирка А. И., Кулешин В. А., Мокрушин А. Д., Мохов Е. Н., Свирида С. В., Шишкин А. В. 12, 2459
- Новый «электронный» механизм энергетической релаксации локальных колебаний сильно возбужденных дефектов. Абакумов В. Н., Пахомов А. А., Шейнман М. К., Ясневич И. Н. 12, 2232
- 3.2. Дислокации и бикристаллы
- Влияние пластической деформации на фотомагнитный эффект и фотопроводимость кристаллах $Cd_{1-x}Hg_xTe$. Гасан-заде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Романов В. А., Сальков Е. А., Шепельский Г. А. 1, 85
- Рекомбинация носителей заряда на дислокациях и радиационных дефектах в p-Si. Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф., Филиппов И. М. 4, 722
- Дислокационная проводимость восстановленного рутила. Девятков М. Н., Кашинцева В. Л., Овчинникова Г. И. 4, 751
- Метаустойчивость дефектов, связанных с дислокациями в сульфиде кадмия. Вывченко О. Ф., Истратов А. А., Хлебов А. Г. 8, 1524
- Коэффициент захвата дырок на плотных дислокационных рядах в полупроводниках при наличии квантующего магнитного поля. Велиев З. А. 8, 1524
- Высокотемпературная пластическая деформация и электрофизические свойства эпитаксиальных структур арсенида галлия. Городниченко О. К., Коваленко В. Ф. 12, 2214
- 3.3. Диффузия и растворимость примесей, влияние отжига, взаимодействия примесей и дефектов
- Рекомбинация носителей заряда в арсениде галлия, содержащем области скопления дефектов. Ломако В. М., Старостин П. Я. 1, 90
- Взаимодействие имплантированных атомов никеля с дефектами и примесями в природном алмазе (по данным люминесценции). Казарян С. А., Гиппиус А. А., Вавилов В. С. 1, 156
- Диффузионное перераспределение марганца в GaAs. Скрятина Е. А., Малкович Р. Ш. 1, 164
- О диффузии водорода в кремнии. Омельниковский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Бородина О. М. 1, 178
- Влияние упругих напряжений, создаваемых компонентами пар Френкеля, на энергетический спектр дефектов в полупроводниках IV группы. Витовский Н. А., Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В. 1, 184
- К модели эффекта радиационно-стимулированного упорядочения в полупроводниках A^{III}B^V. Борковская О. Ю., Дмитрук Н. Л., Липтовченко В. Г., Мищук О. Н. 2, 207
- Влияние термодоноров на радиационное дефектообразование в кремнии. Неймаш В. Б., Сирацкий В. М., Сосянин М. Г., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л. 2, 250
- Взаимодействие лития с радиационными дефектами в кремнии. Заставной А. В., Король В. М. 2, 369
- Твердофазное легирование кремния под действием неперывного излучения CO₂-лазера. Княк С. Г., Кречун В., Маненков А. А., Медиану Р., Михайлова Г. Н., Михзильску И. Н., Прохоров А. М., Урсу И. 3, 421
- Влияние термообработки на люминесцентные свойства эпитаксиальных слоев GaAs, легированных Sn или Te. Брук А. С., Говорков А. В., Мильвидский М. Г., Нуллер Т. А., Шленский А. А., Югова Т. Г. 3, 456
- Аномально-ускоренная диффузия фосфора из ионно-имплантированного слоя кремния под давлением. Васин А. С., Окулич В. И., Пантелеев В. А. 3, 483
- Диффузия скандия в кремнии. Азимов Г. К., Зайнабидинов С., Назыров Д. Э. 3, 556
- Моделирование диффузионного процесса в поликристаллических пленках сульфида кадмия.* Залюбинская Л. Н., Кронберг А. В., Пастернак В. А. 3, 579
- Изменение спектра глубоких уровней в кремневых p-n-переходах под влиянием собственных точечных дефектов.* Выхигин Ю. В., Елисеев В. В., Костылев В. А., Лихунова В. М., Максимова С. А., Соболев Н. А. 3, 581
- Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. I. Теория миграции. Фистуль В. И., Шмугуров В. А. 4, 677
- Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. III. Теория растворимости. Фистуль В. И., Шмугуров В. А. 4, 688
- Уровни дефектов термообработки в кремнии под гидростатическим давлением. Выхигин Ю. В., Земан Я., Костылев В. А., Соболев Н. А., Шмид В. 4, 719
- Влияние германия на образование термодоноров в монокристаллах кремния. Дашевский М. Я., Корляков Д. Н. 4, 732
- Изменение ансамбля центров излучательной рекомбинации в селениде цинка под влиянием термообработки. Сушкевич К. Д., Симашкевич А. В., Коваль А. В. 4, 737
- Некоторые аспекты эффекта радиационного упорядочения. Пахаруков Ю. В. 5, 909
- Скопления атомов меди в германии. Витовский Н. А., Машовец Т. В., Налбандян Л. В. 5, 911
- Эффективность аннигиляции компонентов пар Френкеля на атомах кислорода в Si. Шаховцов В. И., Ясковец И. И. 5, 914

- Влияние кислорода на образование акцепторных уровней никеля в *n*-Si. Витман Р. Ф., Гусева Н. Б., Лебедев А. А., Таптыгов Э. С. 5, 919
- Взаимодействие кислорода с дефектами решетки и примесными атомами в кремнии. Гудев Г. Л., Мьякенькая Г. С. 6, 1042
- Особенности отжига дивакансий в кремнии, содержащем разупорядоченные области. Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. 6, 1076
- Увеличение эффективности электростатического механизма дефектообразования под действием каналированного пучка частиц. Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. 7, 1296
- Влияние никеля на кинетику образования и отжига термических центров в кремнии. Абдурахманов К. П., Ходжаев М. Д., Тешабаев А. Т., Умаров Т. А. 7, 1301
- Механизм взаимодействия атомов золота с донорной примесью в кремнии. Шаймеев С. С., Антонова И. В. 8, 1367
- Поведение меди в процессе распада ее пересыщенного твердого раствора в германии. Яковенко А. Г., Шелонин Е. А. 8, 1390
- Скопление точечных дефектов и их влияние на расстояние носителей заряда в полупроводниках. Артемьев В. А., Витовский Н. А., Михнович В. В. 8, 1395
- Комплексообразование водорода с акцепторными и донорными примесями в кремнии. Гельфанд Р. Б., Мудрый А. В., Пушкарчук А. Л., Ульяшин А. Г. 8, 1448
- Параметры распределения дивакансий в нейтронно-облученном кремнии. Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. 8, 1519
- Кинетика инжекционно-стимулированного преобразования дефектов в светоизлучающих GaAs:Si-структурах. Лев Б. И., Горчинская Т. В., Томчук П. М., Шейнкман М. К. 9, 1529
- Инжекционная, электрополевая и термическая перестройка радиационных дефектов в *p*-кремнии. Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П. 9, 1625
- Влияние процесса радиационного дефектообразования на диффузионный профиль распределения алюминия в кремнии при электронном облучении. Махкамов Ш., Пахаруков Ю. В., Юнусов М. С. 9, 1686
- Изменение электрических параметров полупроводящего GaAs при термообработке. Марков А. В., Степанова И. В., Осверский В. Б., Гришина С. П. 10, 1791
- Диффузия ванадия в кремнии. Азимов Г. К., Зайнабдинов С. З., Козлов Ю. И. 10, 1890
- Исследование диффузии меди в профилированном кремнии, полученном способом А. В. Степанова, Абдурахманов К. П., Закс М. Б., Касаткин В. В., Куликов Г. С., Першеев С. К., Ходжаев К. Х. 10, 1891
- Лазерное твердофазное легирование фосфида индия. Бончик А. Ю., Кияк С. Г., Огнева О. В., Поройков Ю. А., Похмурская А. В., Равич В. Н. 10, 1893
- Влияние ионной бомбардировки на кинетику распада твердого раствора хрома в кремнии. Карзанов В. В., Павлов П. В., Демидов Е. С. 11, 2064
- Исследование скоплений компенсирующих центров в *n*-Si. Витман Р. Ф., Витовский Н. А., Лебедев А. А., Машовец Т. В., Налбандян Л. В. 11, 2066
- Влияние интеркаляции литием на положение уровня Ферми и концентрацию свободных носителей заряда в теллуриде висмута. Григорчак И. И., Лукьянец Б. А., Ковалюк Э. Д., Козьмик И. Д., Бахматюк Б. П., Бойчук В. В. 11, 2083
- Распад преципитатов никеля в монокристаллах кремния под влиянием востороннего сжатия. Зайнабдинов С. З., Тураев А. Р., Фистуль В. И., Ходжаев М. Д. 12, 2118
- Численный расчет профилей радиационно-стимулированной диффузии примесей для случая быстрого термического отжига. Шишияну Ф. С., Показной И. И., Смирнов Е. В., Чебан В. В., Шонтя В. П. 12, 2218
- Влияние кислорода и углерода на поведение марганца в *n*-Si. Лебедев А. А., Абдурахманов К. П., Витман Р. Ф., Гусева Н. Б., Далiev X. С., Утамурадова Ш. Б. 12, 2227

3.4. Сильно легированные полупроводники

- Особенности температурной зависимости холловской подвижности в легированных и некомпенсированных полупроводниках. Банная В. Ф., Веселова Л. И., Гершензон Е. М. 2, 338
- Влияние корреляции в распределении легирующих примесей на спектр краевой люминесценции сильно легированного арсенида галлия. Доманевский Д. С., Жоховец С. В. 4, 693
- Оже-рекомбинация в сильно легированном германии. Карпова И. В., Перель В. И., Сыровегин С. М. 5, 826
- Переход металл—диэлектрик в твердых растворах $Pb_{1-x}Mn_xTe(In)$. Акимов Б. А., Никорич А. В., Рябова Л. И., Широкова Н. А. 6, 1019
- Свойства сильно легированных кристаллов $InP\langle Yb \rangle$ и $InP\langle Er \rangle$. Мастеров В. Ф., Савельев В. П., Штельмах К. Ф., Захаренков Л. Ф. 12, 2229

4. Влияние деформации на зонную структуру и свойства полупроводников

- Влияние одноосной деформации на энергетический спектр и гальваномагнитные явления в бесщелевом *p*-HgMnTe. Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э., Гавалешко Н. П., Фрасуняк В. М. 1, 117

Увлечение дырок ИК излучением в одно-одно деформированном полупроводнике. Баханова Е. В., Васько Ф. Т. 2, 274

Влияние гидростатического давления на характеристики диодов с барьером Шоттки. Скупов В. Д., Цыпкин Г. А., Шенгуров В. Г. 3, 554

Кинетические явления в одноосно деформированном $Hg_{1-x}Cd_xTe$ с $\epsilon_g > 0$. Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э., Инешева О. В. 5, 796

Влияние деформации на энергетический спектр валентной зоны в двумерных полупроводниковых системах. Кибис О. В. 5, 820

Пьезо-холл-эффект в p -кремнии. Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М. 6, 1080

Энергетический спектр мелких акцепторов в сильно одноосно деформированном Ge. Воеводин Е. И., Гершензон Е. М., Гольцман Г. Н., Птицина Н. Г. 8, 1356

Влияние гидростатического давления на концентрацию и подвижность электронов в $Cd_{1-x}Zn_xAs_2$. Лашкул А. В., Цисовски Ян, Арушанов Э. К., Князев А. Ф. 8, 1406

Эффекты горячих дырок в одноосно деформированном n -Ge при $E \parallel P$ [111]. Стариков Е. В., Шикторов П. Н. 8, 1462

Влияние высокого гидростатического давления на экситонный спектр микрокристаллов CdS в стекле. Екимов А. И., Рейнгольд Ф. И., Куликин Б. С. 9, 1556

Одноосно деформированный p - $HgMnTe$ с $\epsilon_g > 0$: гальваномагнитные эффекты, энергетический спектр. Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э. 12, 2190

Переходы от металлической проводимости к активационной в одноосно деформированном n -Ge(Sb). Берча А. И., Ермаков В. Н., Коломоец В. В., Назарчук П. Ф., Панасюк Л. И., Федосов А. В. 12, 2244

5. Кинетические явления

Квантовые поправки к проводимости в полупроводниках с двумерным и трехмерным электронным газом. Эксперимент (обзор). Полянская Т. А., Шарцев Ю. В. 1, 3

Высокочастотная проводимость n - $Cd_xHg_{1-x}Te$ вблизи перехода металл-диэлектрик. Аронзон Б. А., Копылов А. В., Мейлихов Е. З. 3, 471

Новый тип осцилляций кинетических коэффициентов в квантовых структурах. Ляпин И. И., Карягин В. В. 3, 552

Линейная по току энергетическая неоднородность квазичастиц в полупроводниковых слоях. Гредескул Т. С. 3, 568

Температурная инверсия флуктуации тока. Дорин В. А., Лаврентьев А. А., Савицкий О. Г. 8, 1501

Вертикальный транспорт и фотолюминесценция в сверхрешетках. Ларкин И. А. 9, 1664

Механизм тушлевой термостимулированной релаксации тока. Стыс Л. Е. 11, 1971

5.1. Подвижность и механизмы рассеяния

Подвижность носителей тока в твердых растворах $Ge_{1-x}Si_x$. Шаховцов В. И., Шаховцова С. И., Шварц М. М., Шпигар Л. И., Ясковец И. И. 1, 48

Увеличение дрейфовой подвижности носителей заряда в халькогенидных стеклообразных полупроводниках при легировании бромом. Исаев А. И., Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Ятлинко П. И. 1, 181

Влияние крупномасштабных флуктуаций потенциала на явления переноса в полупроводящих кристаллах $CdTe(Cl)$. Агринская Н. В., Аркадьева Е. Н., Терентьев А. И. 2, 231

Особенности температурной зависимости холловской подвижности в легированных и некомпенсированных полупроводниках. Банная В. Ф., Веселова Л. И., Гершензон Е. М. 2, 338

Межзонное смешивание и его влияние на подвижность дырок в ионных полупроводниках с вырожденной валентной зоной. Перлин Ю. Е., Гифейсман Ш. Н., Корочану В. П. 4, 734

Дисперсионный транспорт в материалах с немонотонным энергетическим распределением локализованных состояний. Архипов В. И., Никитенко В. Р. 6, 978

Анизотропные флуктуации подвижности носителей тока и $1/f$ -шум магнитосопротивления в полупроводниках. Орлов В. Б., Якимов А. В. 8, 1341

Скопление точечных дефектов и их влияние на рассеяние носителей заряда в полупроводниках. Артемьев В. А., Витовский Н. А., Михнович В. В. 8, 1395

Расчет отклика электронов на высокочастотное электрическое поле в n -Si. Рагуotis Р. 8, 1426

Энергетическая релаксация и транспорт электронов и дырок в короткопериодичных полупроводниковых сверхрешетках. Иванов С. В., Копьев П. С., Некрасов В. Ю., Пахомов А. Г., Трухин В. Н., Ярошецкий И. Д. 9, 1564

О соотношении подвижностей носителей заряда в полупроводниках n - и p -типа. Грессер Б. Н., Мнацаканов Т. Т. 9, 1658

Рассеяние электронов двумерного газа Ферми на акустических фононах вблизи границы раздела упругих полупространств. Бадалян С. М. 10, 1756

Влияние импульсного лазерного облучения на профиль подвижности и проводимости эпитаксиальных слоев GaAs. Гусakov Г. М., Кодратова Т. Н., Капский А. С., Ларюшин А. И. 10, 1864

ГХ-перенос в реальном пространстве: вклад рассеяния на междолинных фононах. Грибников Э. С., Райчев О. Э. 12, 2171

- Осцилляции Шубникова—де-Гааза в $PbTe(Cr)$. Акимов Б. А., Вертецкий П. В., Зломанов В. П., Рябова Л. И., Тананаева О. И., Широкова Н. А. 2, 244
- О фотостимулированном продольном магнитосопровожении полупроводников. Железняк А. Т., Шмелев Г. М. 2, 376
- Проводимость сплавов $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$ при комбинированном воздействии электрического и магнитного полей. Акимов Б. А., Никорич А. В., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 4, 668
- Переход металл—диэлектрик в бесщелевых полупроводниках $p-Hg_{1-x}Cd_xTe$ с $x \approx 0.15$. Давыдов А. Б., Штрапенин Г. Л. 4, 715
- Гальваномагнитные явления в кристаллах $n-Hg_{1-x-y}Cd_xMn_yTe$ и $n-Hg_{1-y}Mn_yTe$ с $\epsilon_g > 0$. Глузман Н. Г., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Боднарчук О. А., Горбатюк И. Н., Раренко И. М. 6, 1032
- Пьезо-холл-эффект в p -кремнии. Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М. 6, 1080
- О «нулевых осцилляциях» в структурах двумерным электронным газом. Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. 6, 1110
- Об аномалиях электрофизических свойств эпитаксиальных слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As$ и их природе. Виноградова Г. И., Гогаладзе Д. Т., Долгинов А. М., Малькова Н. В., Мильвидский М. Г., Соловьева Е. В. 7, 1177
- О гальваномагнитных явлениях и макроскопически неоднородных пленках вблизи порога протекания в наклонном магнитном поле. Морозовский А. Е., Снарский А. А. 7, 1220
- Диссипативные термо- и гальваномагнитные явления в полупроводниках в произвольных квантовых магнитных полях. Аскеров Б. М., Джафаров М. И. 7, 1275
- Особенности электрофизических и фотоэлектрических свойств монокристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутых лазерному облучению. Вирт И. С., Любченко А. В., Мозоль П. Е., Гнатюк В. А. 8, 1386
- Электропроводность и эффект Холла узкощелевых полупроводников $PbSe(Mn)$ и $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Se(Mn)$. Мисюра И. В. 8, 1475
- Гальваномагнитные явления в сплавах $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ с малой концентрацией In (0.1 ат%) вблизи бесщелевого состояния. Кучеренко И. В., Каширская Л. М., Меллманн К.-П., Ицкевич Е. С. 10, 1784
- Проявление неоднородностей в легированных халькогенидах свинца по гальваномагнитным свойствам. Ковалев А. Н., Остробородова В. В., Парамонов В. И., Фоломин П. И. 11, 2039
- Резонансы гальваномагнитных эффектов в $Hg_{1-x}Cd_xTe$ в сильных электрических

5.3. Теплопроводность, термоэлектрические и термомагнитные явления

- Термоэдс $p-HgMnTe$ в магнитном поле. Гордилов Н. А., Доманская Л. И., Нейфельд Э. А., Шелушина Н. Г. 2, 316
- Термоэлектрические свойства сверхрешеток во внешних полях. Шмелев Г. М., Чайковский И. А., Менса С. И. 4, 712
- Новый гальванотермический эффект, обусловленный электрон-фононным увлечением. Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г. 4, 717
- Ток через полупроводниковую пластину с неравновесными фонами. Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. 5, 905
- Диссипативные термо- и гальваномагнитные явления в полупроводниках в произвольных квантовых магнитных полях. Аскеров Б. М., Джафаров М. И. 7, 1275
- Коэффициент полезного действия термоэлемента при больших тепловых потоках.* Анатычук Л. И., Булат В. П., Булат Л. П., Комолов Е. Н. 7, 1320
- Об эффективности термоэлектрических материалов при больших тепловых потоках.* Анатычук Л. И., Булат Л. П., Комолов Е. Н. 7, 1321
- Нелинейность вольтамперной характеристики монокристалла теллура в условиях электротемпературного эффекта. Степуренко А. А., Алиев К. М., Абакарова Н. С. 9, 1584
- Явления переноса в полупроводниках при электрон-фононном увлечении. Бочков А. В., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. 10, 1752
- Об оптимизации концентрации носителей в полупроводниковых термоэлементах. Жукова Н. М., Кашин А. П., Максимов М. З., Марченко О. В. 10, 1908
- Асимметрия тепловыделения и термоэдс в полупроводниковых микроконтактах. Богачек Э. Н., Шкорбатов А. Г. 12, 2234

5.4. Кинетические явления в сильном электрическом поле. Горячие электроны

- Дрейфовая скорость горячих электронов в обогащенных слоях при нетемпературном характере их распределения по энергии. Вагидов Н. З., Грибников З. С., Иващенко В. М. 2, 304
- Теория квазибаллистического транспорта электронов в биполярном гетеротранзисторе с сильно легированной субмикронной базой. Константинов О. В., Мезрин О. А., Трошков С. И. 3, 508
- Моделирование явлений переноса горячих дырок кремния в $E \parallel H$ полях методом Монте-Карло. Додин Е. П., Красильник З. Ф. 4, 585
- Горячие носители в узкощелевых полупроводниках в сильном электрическом поле.

- Генкин Г. М., Окомельков А. В. 4, 630
- Влияние конечной ширины зоны проводимости на ионизацию примесных центров в условиях воздействия сильных внешних полей. Крючков С. В., Сыродоев Г. А. 5, 857
- Туннельная ионизация примесных атомов фосфора в кремнии при температуре 4.2 К. Охонин С. А., Французов А. А. 8, 1362
- Расположение джентрированной электронно-дырочной плазмы высокой плотности в пленках арсенида галлия. Ващенко В. А., Кернер Б. С., Осипов В. В., Синкевич В. Ф. 8, 1378
- Расчет отклика электронов на высокочастотное электрическое поле в n -Si. Рагуотис Р. 3, 1426
- Нелинейная вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводников в сильном электрическом поле. Джабер А. М., Качлишвили З. С. 8, 1500
- СВЧ шум горячих электронов в GaAs при температурах кристалла 10—100 К. Аитов Р. Д., Маслов А. И., Ржевкин К. С. 9, 1640
- К теории плазменных волн в слоистых структурах. Ермолин А. В., Кучма А. Е., Свердлов В. А. 9, 1709
- Возможные квантовые особенности одномерного баллистического транспорта в полупроводниковых структурах. Вьюров В. В., Федирко В. А. 9, 1713
- Разогрев носителей тока и фононов постоянным электрическим полем. Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. 10, 1895
- Исследование процессов квазibalлистического транспорта электронов в прямозонных полупроводниковых соединениях типа A^mB^v . Караваев Г. Ф., Ткаченко Е. А., Уйманов Е. В. 11, 1938
- 5.5. Кинетика неупорядоченных систем, прыжковый перенос
- Эффект Френкеля—Пула в области прыжковой проводимости в слабо компенсированных полупроводниках. Аладашвили Д. И., Адамия З. А., Лавдовский К. Г., Левин Е. И., Шкловский Б. И. 2, 213
- Прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка в кристаллах n -ZnSe в умеренно сильных электрических полях. Тимченко И. Н., Касиян В. А., Недеогло Д. Д., Симашкевич А. В. 2, 240
- Проводящая зона в условиях структурного беспорядка. Гинзбург Л. П. 5, 813
- Локализованные состояния в условиях структурного беспорядка. Гинзбург Л. П. 9, 1629
- Теория прыжковой фотопроводимости при длинноволновом возбуждении. Рузин И. М. 10, 1831
- 5.6. Шумы в полупроводниках
- Модель объемного шума $1/f$ в полупроводниках. Дьяконова Н. В. 2, 283
- Влияние дефектов структуры на интенсивность $1/f$ -шума в n - $Cd_{1-x}Hg_xTe$. Бакиш И. С., Гринь В. Ф., Карачевцева Л. А., Кодадлашвили М. З., Сальков Е. А., Хижняк Б. И. 3, 571
- Модель объемного шума $1/f$ в лавинно-пролетных диодах. Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. 7, 1187
- Фотоэлектрические и шумовые свойства пластически деформированных монокристаллов $Cd_{1-x}Hg_xTe$. Андрухиц М. Г., Вирт И. С., Цюцюра Д. И., Шуптар Д. Д., Шкумбатюк П. С. 7, 1263
- Анизотропные флуктуации подвижности носителей тока и $1/f$ -шум магнитосопротивления в полупроводниках. Орлов В. Б., Якимов А. В. 8, 1341
- СВЧ шум горячих электронов в GaAs при температурах кристалла 10—100 К. Аитов Р. Д., Маслов А. И., Ржевкин К. С. 9, 1640
- Шум $1/f$ и долговременная релаксация фотопроводимости в GaAs. Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. 10, 1828
- $1/f$ -шум дисков Корбино из InSb в сильных магнитных полях. Аלקеров С. А., Кенгерли Д. Ф. 12, 2138
- Исследование природы шума в нестабильных GaP: N-светодиодах. Лисянский М. И., Лукьянчиков А. Н. Б. 12, 2143
6. Распространение звука, акустоэлектрические и фотоакустические явления
- Исследование поглощения ультразвука в расплаве антимиониды галлия и индия. Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т. 1, 187
- Аномальное поведение затухания акустоэда в эпитаксиальных слоях арсенида галлия. Лубяная М. Д., Марончук И. Е., Юцис А. И. 2, 364
- Акустическая регистрация удержания фото-возбужденной невырожденной электронно-дырочной плазмы вблизи поверхности германия. Гусев В. Э., Жданов Б. В., Кузнецов В. И., Петросян Е. Г., Теленков С. А. 2, 366
- Анизотропные планарные акустомагнитно-электрические эффекты на мезоультразвуке в произвольных (классических) магнитных полях.* Липник А. А. 3, 580
- Исследование спектров примесного поглощения a - $Si_{1-x}C_x$: Н методом фотоакустической спектроскопии. Балагуров Л. А., Карпова Н. Ю., Омеляновский Э. М., Сизов В. Е. 4, 673
- Электронно-механический резонанс на глубоких центрах в $p^+-p^0-\pi-n^0$ -структурах арсенида галлия. Лебедев А. А., Митрохин В. И., Рембеза С. И., Свиридов В. В., Степанова М. Н., Ярославцев Н. П. 5, 897
- Дисперсионные свойства поверхностных волн на границе раздела двух полупроводников, ограниченных металлическими поверхностями.* Остриков К. Н. 7, 1320
- Распространение звука в расплавах селена

- и теллура. Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т. 8, 1469
- Исследование температурной зависимости скорости звука и сжимаемости в расплавленном кремнии. Глазов В. М., Ким С. Г., Нуров К. В. 10, 1834
- Электростимулированное примесное поглощение ультразвука в полупроводниках со сверхструктурой.* Крючков С. В. 10, 1917
- О генерации звука при воздействии на поверхность полупроводника лазерного излучения. Захарова А. А., Рыжий В. И. 11, 1976
- ## 7. Распространение электромагнитных волн
- Резонансные явления в структурах Шоттки при возбуждении «медленных» поверхностных электромагнитных волн. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Румянцев В. Л., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 3, 461
- Влияние амплитудной решетки на дифракционную эффективность динамических голограмм в кремнии. Балтрамеюнас Р., Велецкас Д. 3, 517
- Влияние перезарядки мелких примесей на дефокусировку лазерного луча в кристаллах кремния. Балтрамеюнас Р., Велецкас Д. 7, 1214
- Усиление электромагнитного излучения в экситонной области спектра полупроводника. Неркарян Х. В. 9, 1691
- Влияние тонкого диэлектрического слоя на свойства ПЭВ на границе металл—полупроводник. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Макарова Т. Л., Румянцев В. Л., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 11, 1966
- ## 8. Резонансные явления в полупроводниках
- Влияние случайных полей на спектр ЭПР акцепторов Mn_{Ga} в p -GaAs. Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Красикова О. Г., Осипов Е. Б., Решиков М. А. 1, 73
- Циклотронный резонанс тяжелых дырок Ge с положительными эффективными массами в условиях многопучкового стриминга в $E \parallel V$ полях. Стариков Е. В., Шикторов П. Н. 3, 532
- Частотная зависимость ширины линии ЭПР в аморфном кремнии в интервале 9–130 ГГц. Бугай А. А., Заридкий И. М., Лукин С. Н., Неймарк Е. И., Кабдин Н. Н. 5, 872
- ЭПР и магнитная восприимчивость дефектных кристаллов $A_2^{III}B_3^{VI}$, легированных марганцем. Аскеров И. М., Мастеров В. Ф., Романов В. В., Штельмах К. Ф. 7, 1305
- О состояниях примеси европия в дефектных соединениях $A_2^{III}B_3^{VI}$ по данным ЭПР и эффекта Мессбауэра. Аскеров И. М., Кобелев В. Ф., Мастеров В. Ф., Тагиев О. В., Штельмах К. Ф., Лихолит Л. Ф. 7, 1307
- ## 9. Оптические и магнитооптические явления
- Оптические свойства и электронная структура полупроводников сульфидов и оксидов редкоземельных металлов (обзор). Жузе В. П., Шелых А. И. 3, 393
- Гигантские спиновые расщепления экситонных состояний в вав-флековском магнитосмешанном полупроводнике $Zn_{1-x}Fe_xTe$. Абрамишвили В. Г., Комаров А. В., Рябенко С. М., Погорелый В. И. 3, 575
- Перестройка спектра излучения светодиода магнитным полем. Викулин И. М., Ирха В. И., Коробицын Б. В. 6, 1006
- Индупированные магнитным полем электронные переходы в полупроводниках со сверхрешеткой. Поляновский В. М. 9, 1680
- Оптические свойства монокристаллов $AgGaTe_2$. Константинова Н. Н., Рудь Ю. В. 10, 1778
- Энергетический спектр легких и тяжелых дырок в разбавленных магнитных полупроводниках в магнитном поле. Погорелов Р. В., Заболоцкий Е. И. 10, 1796
- ### 9.1. Поглощение, отражение и рассеяние света
- Деформация поверхности полупроводника при локальном освещении. Васильев А. Н., Сабликов В. А. 1, 33
- «Оптическая откачка» спинов носителей заряда стимулированной люминесценцией. Джиоев Р. И., Кавокин К. В., Курсаев Ю. Г., Меркулов И. А. 1, 104
- Оптическое поглощение и люминесценция твердых растворов $(SiC)_{1-x}(AlN)_x$. Нурмагомедов Ш. А., Пихтин А. Н., Разбегаев В. Н., Сафаралиев Г. К., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. 1, 162
- Влияние примесей In и Cl на линейное электропоглощение в CdTe. Мартынов В. Н., Соловьев А. Н., Шадин Ю. В., Зерагия Э. М. 1, 168
- Температурная зависимость формы линии фототермической ионизации примесей в слабо легированном слабо компенсированном полупроводнике. Барановский С. Д., Шкловский Б. И. 1, 192
- Край оптического поглощения и деформации эпитаксиальных слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As$. Абдуллаев М. А., Гореленок А. Т., Кохановский С. И., Макушенко Ю. М., Пуляевский Д. В., Сейсян Р. П., Штенгель К. Э. 2, 201
- Поглощение света свободными носителями в узкозонных полупроводниках в области собственной проводимости.* Барановский П. И., Городничий О. П., Шевченко Н. В., Боднарук О. А. 3, 579
- К теории внутризонного оптического поглощения в гетероструктурах с квантовыми ямами. Осипов В. В., Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. 5, 809
- Край собственного поглощения $Al_xGa_{1-x}As_{1-y}P_y$. Кузнецов В. В., Разбегаев В. Н., Саидэль-Гизирей 5, 880
- Электрические и оптические свойства полупроводников твердых растворов $Hg_{1-x}Cd_xMn_ySe$. Гавалешко Н. Н., Кри-

- вень С. И., Мазур Ю. И., Паранчич С. Ю., Сизов Ф. Ф. 6, 943
- Край оптического поглощения «чистых» эпитаксиальных слоев InP. Абдуллаев М. А., Кохановский С. И., Макущенко Ю. М., Сейсян Р. П. 7, 1156
- «Тонкая» структура края поглощения кристаллов теллурида кадмия. Абдуллаев М. А., Кохановский С. И., Кошуг О. С., Сейсян Р. П. 7, 1160
- Наблюдение примесных состояний в высокоомном арсениде галлия методом фотоотражения. Пихтин А. Н., Айраксинен В.-М., Липсанен Х., Туоми Т. 7, 1280
- Анизотропия длинноволнового оптического поглощения монокристаллов CuInTe_2 . Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. 7, 1299
- Спектр поглощения структур с квантовыми ямами. Копьев П. С., Решина И. Н. 7, 1316
- Зоны и оптические спектры селенида висмута. Соболев В. В., Крамарь В. М., Козлова С. Г., Темчук Г. И. 8, 1430
- Спектроскопическое определение степени компенсации и концентрации примесей в высокочистом GaAs. Барановский С. Д., Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Осутин А. В. 8, 1434
- Особенности рассеяния коротких световых импульсов на светоиндуцированных решетках в кремнии. Некрасов В. Ю., Трухин В. Н., Ярошецкий И. Д. 8, 1512
- Нелинейное поглощение света в $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. Средин В. Г., Укроженко В. М. 10, 1762
- Многофотонное поглощение компоненты бихроматической волны в полупроводнике в скрещенных электрическом и магнитном полях. Монозон Б. С., Игнатьева Л. А. 10, 1800
- Плазмон-фононное возбуждение в арсениде галлия *n*-типа. Богданова В. А., Люзе Л. Л., Семиколенова Н. А. 10, 1900
- 9.2. *Нелинейная оптика*
- Исследование оптического усиления в сверхрешетках $\text{GaAs}-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. Балтрамеюнас Р., Вайнерт Х., Геразимас Е., Куокштис Э., Ханнебергер Ф. 5, 792
- Нелинейно-оптические явления в волноводной $P-i-N$ ДГС при эффекте Франца—Келдыша. Толстихин В. И., Долманов И. Н. 11, 1997
- 9.3. *Экситоны и электронно-дырочные капли*
- Гашение экситонной люминесценции в результате ударной ионизации и механизмы релаксации электронов в сульфиде кадмия. Каган В. Д., Карпенко С. Л., Катилус Р. В., Мюллер Г. О., Сейсян Р. П., Якобсон М. А. 1, 138
- Рассеяние поляритонов и локализация экситонов на флуктуациях состава $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$. Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Сальков Е. А. 1, 174
- Экситонная люминесценция кремния, легированного фосфором и галлием в концентрациях $5 \cdot 10^{16} \div 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Горбунов М. В., Каминский А. С. 2, 359
- Акустическая регистрация удержания фотовозбужденной невырожденной электронно-дырочной плазмы вблизи поверхности германия. Гусев В. Э., Жданов Б. В., Кузнецов В. И., Петросян Е. Г., Теленков С. А. 2, 366
- Исследование диффузии свободных экситонов в $3C\text{-SiC}$ -светодиодах. Авраменко С. Ф., Киселев В. С., Махлин А. Н. 3, 521
- О влиянии неоднородности распределения электронов и дырок на спектры излучения электронно-дырочной плазмы. Батырев В. А., Лукашевич П. Г. 3, 550
- Кинетика возгорания люминесценции остывающей электронно-дырочной плазмы в кристалле CdSe. Балтрамеюнас Р., Юршенас С., Жукаускас А., Куокштис Э., Латинис В. 3, 565
- Тонкая структура спектров связанного экситона в тетрагональном дифосфиде цинка. Сырбу Н. Н., Морозова В. И., Стратан Г. И. 10, 1771
- Три световые волны в области экситонного резонанса в кристаллах CdS. Винецкий В. Л., Кудыкина Т. А. 10, 1910
- Спектральные и временные характеристики термически дelokализованных экситонов в твердом растворе $\text{CdS}_{1-x}\text{Se}_x$. Агекян В. Ф., Александров Б. Г., Степанов Ю. А. 11, 1951
10. *Действие излучений на полупроводник и свойства радиационных дефектов*
- Кинетика накопления доноров в селениде свинца при корпускулярном облучении. Казаринов Ю. Н., Ломасов В. Н. 1, 177
- K модели эффекта радиационно-стимулированного упорядочивания в полупроводниках Al^{11}V . Борковская О. Ю., Дмитриук Н. Л., Литовченко В. Г., Мищук О. Н. 2, 207
- Рентгеночувствительность моноселенида галлия. Арутюнян В. М., Димаксян М. Л., Элбакян В. Л., Григорян Г. Е. 3, 505
- Кооперативные эффекты в кильватере быстрых ориентированных частиц в полупроводниках. Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. 5, 832
- Особенности образования рекомбинационных центров при облучении бездислокационного *n*-Si. Колковский И. И., Лугаков П. Ф., Шуша В. В. 5, 885
- Формирование проводящих слоев при облучении поверхности кремния лазерной плазмой бора и при последующем отжиге. Калягин М. А., Стриковский М. Д. 6, 964
- Увеличение эффективности электростатического механизма дефектообразования под действием каналированного пучка частиц. Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. 7, 1296
- Накопление и отжиг основных компенсирующих радиационных дефектов в $p\text{-Si}(\text{Ge})$. Кузнецов В. И., Луга-

- ков П. Ф., Салманов А. Р., Цикунов А. В. 8, 1492
- Радиационно индуцированная стратификация заряда в узкозонных полупроводниках. Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. 11, 1992
- 10.1. Облучение γ -квантами, электронами и позитронами
- Поведение примеси золота в кремнии при радиационно-термических воздействиях. Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. 2, 253
- Аннигиляция позитронов в разупорядоченных областях Ge и Si, облученных нейтронами. Пустовойт А. К., Коноплева Р. Ф., Купчишин А. И., Лукашев К. М. 2, 257
- Исследование методом аннигиляции позитронов дефектов в монокристаллах кремния, облученных ионами ксенона. Гирка А. И., Клопиков Е. Б., Скуратов В. А., Шишкин А. В. 2, 328
- Взаимодействие лития с радиационными дефектами в кремнии. Заставной А. В., Король В. М. 2, 369
- Эффективность образования точечных дефектов в n - и p -Ge в условиях облучения при 77 и 300 К. Витовский Н. А., Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В., Полоскин Д. С. 3, 425
- Особенности образования радиационных дефектов в высокоомном кремнии.* Лугаков П. Ф., Лукашевич Т. А. 3, 581
- Рекомбинация носителей заряда на дислокациях и радиационных дефектах в p -Si. Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф., Филиппов И. М. 4, 722
- Особенности накопления рекомбинационных центров при облучении p -Si. Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф., Филиппов И. М. 4, 748
- Скорость введения в профиль концентрации А-центров в n -кремнии, облученном электронами с энергией вблизи порога дефектообразования. Берман Л. С., Витовский Н. А., Воронков В. Б., Ломасов В. Н., Ременюк А. Д., Ткаченко В. Н., Толстобров М. Г. 4, 753
- Влияние температуры на эффективность аннигиляции первичных радиационных дефектов в высокоомном кремнии при γ -облучении. Лукашевич Т. А., Мирухин Л. В. 5, 865
- Образование центров $E10$ ($E_c - 0.62$ эВ) в области пространственного заряда и нейтральном объеме n -InP при электронном и γ -облучении. Бакин Н. Н., Брудный В. Н., Пешев В. В., Смородинов С. В. 5, 890
- Влияние электронного облучения на характер низкотемпературной проводимости и емкости в кремниевых МДП структурах. Галаев А. А., Выговская Е. А., Малинкович М. Д. 5, 916
- Влияние облучения электронами на свойства фосфида индия, легированного $3d$ -элементами. Саморуков Б. Е., Слободчиков С. В. 5, 921
- Исследование флукуаций удельного сопротивления в γ -легированном кремнии. Гриштелей П. М., Гучетль Р. И., Заблоцкий В. В., Иванов Н. А., Космач В. Ф., Леонов Н. Н., Петренко В. В., Стук А. А., Федоров В. В., Харченко В. А., Юрова Е. С. 6, 1088
- Краевая фотолуминесценция кристаллов n -InP, облученных электронами с энергией 3.5–4 МэВ. Коршунов Ф. П., Радауцан С. И., Соболев Н. А., Тигиняну И. М., Урсаки В. В., Кудрявцева Е. А. 9, 1581
- Влияние γ -облучения на генерацию носителей заряда в МДП структурах на основе кремния. Безлюдный С. В., Колесников Н. В., Санин К. В., Суриков И. Н., Хансеваров Р. Ю., Якименко А. Н. 10, 1888
- Влияние глубоких центров, введенных в $GaAs_{1-x}P_x$ ионной имплантацией и электронным облучением, на спектральные характеристики фоточувствительных структур. Кольцов Г. И., Юрчук С. Ю. 10, 1906
- Влияние зарядовых состояний вакансий на накопление дивакансий в кремнии при электронном облучении. Колесников Н. В., Ломасов В. Н., Мальханов С. Е. 11, 1921
- О природе радиационных дефектов в n -кремнии, облученном электронами с энергией вблизи порога дефектообразования. Берман Л. С., Желко В. А., Ломасов В. Н., Ткаченко В. Н. 12, 2129
- Влияние параметров импульсного электронного облучения на эффективность образования дефектов в кремнии. Абдусаттаров А. Г., Емцев В. В., Машовец Т. В. 12, 2221
- 10.2. Облучение нейтронами и протонами
- Механизмы излучательной рекомбинации в ядро легированном арсениде галлия. Быковский В. А., Тирый В. А., Коршунов Ф. П., Утенко В. И. 1, 79
- Влияние облучения протонами на люминесценцию арсенида галлия. Глинчук К. Д., Заяц Н. С., Прохорович А. В. 4, 657
- О структурных изменениях в стеклообразном AsGeSe, облученном большими дозами нейтронов. Конорова Л. Ф., Жданович Н. С., Дидик В. А., Прудников И. М. 4, 706
- Влияние облучения 50 МэВ протонами на ИК поглощение в кремнии. Гроза А. А., Куц В. И., Литовченко П. Г., Хиврич В. И. 6, 975
- Образование радиационных дефектов в пленках PbSe при облучении α -частицами. Фреик Д. М., Салий Я. П., Межиловская Л. И., Собкович Р. И., Школьный А. К., Огородник Я. В. 6, 1015
- О влиянии ядерного легирования на радиационное дефектообразование в Si(Ge). Воєводов А. В., Коршунов Ф. П., Соболев Н. А., Стук А. А. 7, 1173
- Параметры распределения дивакансий в нейтронно-облученном кремнии. Анто-

нова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. 8, 1519
О положении локальных уровней радиационных дефектов в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe$, облученных протонами. Брандт Н. Б., Гасков А. М., Ладыгин Е. А., Скипетров Е. П., Хорош А. Г. 11, 2034

10.3. Облучение ионами и ионное легирование

О механизме формирования скоплений междоузельных атомов в кремнии при высокотемпературной ионной имплантации. Асеев А. Л., Федина Л. И. 1, 171
Влияние термодоноров на радиационное дефектообразование в кремнии. Неймаш В. Б., Сиравский В. М., Соcнин М. Г., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л. 2, 250

Исследование методом аннигиляции позитронов дефектов в монокристаллах кремния, облученных ионами ксенона. Гирка А. И., Клопиков Е. Б., Скуратов В. А., Шишкин А. В. 2, 328

Электрофизические свойства пленок $PbTe$, облученных ионами аргона. Аброян И. А., Алиев Б. З., Имамкулиев С. Д., Казьмин С. А., Кайданов В. И., Касаманли Г. Д. 2, 352

Имплантация азота в кремний при 700—1100 °С. Качурин Г. А., Тысченко И. Е., Попов В. П., Тийс С. А., Плотников А. Е. 3, 434

Влияние плотности ионного тока при имплантации на эффект дальнего действия в кристаллах кремния с примесью железа. Демидов Е. С., Карзанов В. В., Павлов П. В. 3, 548

Ионно-стимулированное восстановление кристаллической структуры $GaAs$. Аброян И. А., Беляков В. С., Крысов Г. А., Титов А. И. 5, 892

Особенности разупорядочения $GaAs$ при ионной имплантации азота. Акимченко И. П., Алещенко Ю. А., Дымова Н. Н., Заветова М., Краснопопцев В. В. 6, 1093

Электрические свойства имплантированных He^+ , Cu^+ , Ag^+ и термически отожженных кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. Ибрагимова М. И., Барышев Н. С., Хайбуллин И. Б., Ахмедова Ф. И., Фадеева А. П. 7, 1249

Исследование поведения примесей при ионной имплантации селеном $GaAs$. Евгенийев С. Б., Лапкина И. А., Озеров Ю. П., Уфимцев В. Б. 8, 1347

Немонотонный характер дозовой зависимости электрических свойств и химической стойкости азотированного ионной имплантацией кремния. Лобанова Н. Е., Павлов П. В., Тетельбаум Д. И., Потапова Л. В. 12, 2149

Политипный фазовый переход, индуцированный ионной имплантацией. Москвина Д. Р., Пецольдт Й., Потапов Е. Н., Таиров Ю. М. 12, 2240

10.4. Действие лазерного облучения

Твердофазное легирование кремния под действием непрерывного излучения CO_2 -

лазером. Кияк С. Г., Крачун В., Маненков А. А., Медчану Р., Михайлова Г. Н., Михэилеску И. Н., Прохоров А. М., Урсу И. 3, 421

Вольтамперные характеристики контактов $Pd-GaAs$, подвергнутых лазерному отжигу. Воронков В. П., Вяткин А. П., Иванов Б. В., Кулешов С. М., Рухадзе З. А. 3, 562

Исследование лазерной диффузии в $GaAs$ n - и p -типа проводимости. Аракелян В. С., Бархударян Г. Р. 4, 640

Влияние импульсного лазерного облучения на профиль подвижности и проводимости эпитаксиальных слоев $GaAs$. Гусakov Г. М., Кодратова Т. Н., Капский А. С., Ларюшин А. И. 10, 1864

О механизме образования пространственно-неоднородных структур в полупроводниках под действием мощного лазерного излучения. Захарова А. А., Рыжий В. И. 10, 1898

Образование упорядоченных структур на поверхности $GaAs$ при импульсном лазерном облучении. Кашиаров П. К., Петров В. И., Птицын Д. В., Тимошенко В. Ю. 11, 2080

11. Явления неустойчивости

Импеданс фотопроводника при параметрической неустойчивости волны пространственного заряда. Алимписев В. Н., Гуральник И. Р. 2, 372

Отрицательное дифференциальное сопротивление при охлаждении электронов в неоднородно легированном полупроводнике. Гуревич Ю. Г., Зозуля В. Л., Юрченко В. Б. 4, 643

Отрицательная фотопроводимость на пороге возбуждения осциллятора. Владимиров В. В., Каплан Б. И., Коллюх А. Г., Малютенко В. К. 6, 1104

Винтовая неустойчивость в Ge в условиях эсксклюзии носителей заряда. Владимиров В. В., Каплан Б. И., Коллюх А. Г., Малютенко В. К. 6, 1106

Токовая неустойчивость, обусловленная фазовым переходом полупроводник—металл в квазиодномерных структурах. Вакаров Б. С., Вакарова И. С., Корляков А. Б., Кравченко С. Н., Петухов А. Г. 7, 1182

О рекомбинационных волнах в условиях эсксклюзии. Карпова И. В., Сабликов В. А. 7, 1293

Численное моделирование микроплазменной неустойчивости. Намаюнас А. М., Пожела Ю. К., Тамашевичюс А. В. 9, 1606

Неустойчивость тока в кремнии, компенсированном марганцем, связанная с рекомбинационными волнами. Бахадырханов М. К., Парманкулов И. П. 9, 1646

Механизм генерации электрических колебаний, усиления фототока и S -образной ВАХ в ПДП структурах. Малик А. И., Гречко В. А., Грушка Г. Г. 11, 2049

Эффект Ганна и субмиллиметровая ОДП в E₁-N полях. Дзамукашвили Г. Э., Качлишвили З. С. 6, 1101
 Возбуждение продольных колебаний решетчатых доменами Ганна в периодически легированном образце. Баканас Р. К., Басс Ф. Г. 7, 1243

11.2. Ударная ионизация и пробой

Температурная зависимость ударной ионизации и лавинного пробоя в карбиде кремния. Константинов А. О. 1, 52
 Влияние быстроосциллирующего движения электронов в сильном магнитном поле на ударную ионизацию. Каган В. Д. 1, 96
 Гашение экситонной люминесценции в результате ударной ионизации и механизмы релаксации электронов в сульфиде кадмия. Каган В. Д., Карпенко С. Л., Кагилюс Р., Мюллер Г. О., Сейсян Р. П., Якобсон М. А. 1, 138
 Ударная ионизация глубоких уровней в лавинно-пролетных диодах на основе арсенида галлия. Лукьянчикова Н. Б. 2, 332
 Умножение фотовозбужденных носителей заряда при ударной ионизации примесных атомов в полупроводниках. Пенин Н. А. 3, 466
 Однородный лавинный пробой в кремниевых диодах. Зубрилов А. С., Котин О. А., Шуман В. Б. 4, 607
 Шурование лавинного пробоя в карбиде кремния. Константинов А. О. 6, 985
 Температурная зависимость напряжения лавинного пробоя p-n-переходов с глубокими уровнями. Режим релаксационной задержки пробоя. Кюреган А. С., Шлыгин П. Н. 7, 1164
 Измерение концентрации плазмы при попережном пробое в n-InSb. Ботте В. А., Владимиров В. В., Горшков В. Н., Липтуга А. И., Малютенко В. К. 7, 1303
 О возможности появления хаотических решений в модели узкозонного полупроводника в режиме ударной ионизации. Безручко Б. П., Ерастова Е. Н. 9, 1707
 Напряжение лавинного пробоя p-n-переходов на основе Si, Ge, SiC, GaAs, GaP и InP при комнатной температуре. Кюреган А. С., Юрков С. Н. 10, 1819

12. Неравновесные процессы в полупроводниках

Спиновое эхо в системе свободных электронов полупроводника. Волков А. С., Липко А. Л., Меретлиев Ш. М., Царенков Б. В. 12, 2179

12.1. Фотоэлектрические и фотомагнитные явления. Фотопроводимость и фотоэдс

Кинетика фотоотклика и спектры Q-DLTS гетероструктур с изолирующим слоем Al_{0.3}Ga_{0.7}As, изготовленных МОС гидридным методом. Поляков В. И., Перов П. И., Ермаков О. Н., Ермаков М. Г., Руковишников А. И., Сергеев В. И. 1, 125

Поляризационная фоточувствительность барьеров электролит-CdGeP₂. Горячев Д. Н., Рудь Ю. В., Таиров М. А. 2, 312
 Фотоприемник УФ излучения на базе пленки Zn_xCd_{1-x}S. Книгин П. И., Мисагатов Ш. А., Розиков Х. 2, 356
 Определение приповерхностного изгиба зон по кинетике барьерно-ловушечной фотоэдс. Бедный Б. И., Василевский М. И., Карпович И. А. 2, 362
 Модель аномальной фотопроводимости. Стыс Л. Е. 2, 378
 Рентгеночувствительность моноселенида галлия. Арутюнян В. М., Димаксян М. Л., Элбакян В. Л., Григорян Г. Е. 3, 505
 К теории вертикального ЛСР фоторезистора. Кондратьева О. Г., Неустровев Л. Н., Осипов В. В. 3, 536
 Отрицательная дифференциальная фотопроводимость в МТДП структурах. Манассон В. А., Комиссаров Г. П. 3, 557
 Фотоэлектрические свойства AlGaAs-GaAs-гетероструктур с туннельно-тонким «иризонным окном». Андреев В. М., Воднев А. А., Ларионов В. Р., Прудских Т. А., Румянцев В. Д., Расулов К. Я., Хвостиков В. П. 4, 597
 Электрические и фотоэлектрические свойства пленок стеклообразного сульфида мышьяка, фототермолегированного цинком. Колобов А. В., Любин В. М., Тягирджанов М. А. 4, 601
 Теория фотогальванических эффектов в кристаллах без центра инверсии простой зоны. Гармоническое приближение. Расулов Р. Я. 4, 698
 Длинноволновая фотопроводимость компенсированного германия с медью. Дружинин Ю. П., Чиркова Е. Г. 4, 756
 Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных арсенид-галлиевых p⁺-ν-π-n⁺-структур. Воронин С. Т., Кравченко А. Ф., Шерстяков А. П., Горбушов К. В. 5, 787
 Особенности эффекта устойчивой фотопроводимости в селективно легированных двойных гетероструктурах GaAs/n-(Al, Ga)As. Евтихийев В. П., Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. 5, 845
 Нестационарный фотоэффект в варизонной m-p-n-структуре. I. Распространение импульса неравновесных носителей заряда. Резников Б. И., Царенков Г. В. 5, 849
 Фотоэффект в гетероструктурах In₂O₃/CuInSe₂, полученных методом термического окисления. Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. 5, 869
 Влияние поверхностных явлений на фотоэлектрические свойства CdCr₂Se₄. Абдуллаев А. А., Гаджиев А. З. 5, 876
 Отрицательная дифференциальная фотопроводимость. Эффект ИК гашения фотопроводимости. Лукьянченко А. И. 5, 882

- Определение рекомбинационных параметров тонкобазных фотоэлектрических преобразователей на основе анализа световой вольтамперной характеристики. Анюшин Ю. А., Базин В. М., Даревский А. С. 6, 937
- Спектры fotocувствительности структур Cu-CdSiP_2 . Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. 6, 1002
- Чувствительность гетероструктур Ge-GaAs к освещению в области вакуумного ультрафиолета. Макаров О. А., Неизвестный И. Г., Синюков М. П., Супрун С. П., Шумский В. Н. 6, 1038
- Структурная чувствительность кривых фотоздс в условиях образования стоячей рентгеновской волны в полупроводнике $s-p-n$ -переходом. Ковальчук М. В., Ковн В. Г., Лобанович Э. Ф. 6, 1054
- Теория когерентного фотогальванического эффекта. Энтин М. В. 6, 1066
- Кинетика фотопроводимости в легированном хромом CdIn_2S_4 . Адомайтис Э., Викторавичюс В., Галдикас А., Гребинский С. 6, 1096
- Фотомагнитная ЭДС в Ge, возбуждаемая поляризованным светом. Зыков В. Г., Сердега Б. К. 6, 1118
- Фотоэлектрическое усиление лавинных гетероструктур с тонким широкозонным слоем. Осипов В. В., Панкратов А. А., Холоднов В. А. 7, 1148
- Нестационарный фотоэффект в варизонной $m-p-n$ -структуре. II. ЭДС холостого хода. Резников Б. И., Царенков Г. В. 7, 1235
- Инжекционное оочувствление симметричных МПМ структур на основе CdSe(Ag) в среднем диапазоне ИК света. Зобов Е. М., Ризаханов М. А. 7, 1291
- Фотопроводимость эпитаксиальных слоев $n\text{-Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$. Назаренкова Т. И., Сальков Е. А., Сочинский Н. В. 7, 1309
- Оптическая перезарядка примесных центров многозарядных акцепторов при комбинированном и монополярном фотовозбуждении носителей в полупроводниках. Корнилов Б. В. 8, 1329
- Механизмы нестационарной фотопроводимости в селективно легированных гетероструктурах $\text{GaAs}/n\text{-(Al, Ga)As}$. Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. 8, 1382
- Магнитоспектроскопия комплекса D(H, O) в германии. Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Кропотов Г. И., Халлер Ю. Э. 8, 1440
- Полевые фототранзисторы с $p-n$ -переходом на основе $\text{Pb}_{0.75}\text{Sn}_{0.22}\text{Te}$. Абрамян Ю. А., Папазян К. З. 8, 1486
- Фотопроводимость $p\text{-Ge}$ при низких температурах, возбуждаемая излучением импульсного CO_2 -лазера. Васецкий В. М., Гайдар А. В., Порошин В. Н., Саркисян Э. С. 8, 1508
- Исследование центров fotocувствительности в инжекционных слоях CdSe . Черкасов Ю. А., Буров П. А., Давыдов И. А., Лучина В. Г., Одринский А. П., Румянцев А. И. 9, 1572
- Эффективная модуляция излучения и N -образная ВАХ для фототока при электропоглощении света в двойной $P-i-N$ -гетероструктуре. Бутусов Д. М., Гоцадзе Г. Г., Рывкин Б. С. 9, 1601
- Пикосекундная фотопроводимость в CdCr_2Se . Балинас В., Галдикас А., Кроткус А., Сталенис А., Аминов Т. Г. 10, 1859
- Магнитоспектроскопия литийсодержащих доноров в германии. Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Кропотов Г. И. 10, 1874
- Спектральная память фотопроводимости вислокоомного ZnSe . Горя О. С., Ковалев Л. Е., Коротков В. А., Маликова Л. В., Симашкевич А. В. 11, 2090
- Барьерная фотопроводимость в эпитаксиальных пленках GaAs и InP . Карпович И. А., Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Планкина С. М., Степихова М. В., Шилова М. В. 12, 2164

12.2. Фото- и электролюминесценция, катодолюминесценция

- Стационарная и разрешенная во времени фотолюминесценция монокристаллов фосфида кадмия. Арушанов Э. К., Кулюк Л. Л., Натепров А. Н., Радауца С. И., Шемякова Т. Д., Штанов А. А. 1, 58
- Механизмы излучательной рекомбинации в ядро легированном арсениде галлия. Быковский В. А., Гирий В. А., Коршунов Ф. П., Утенко В. И. 1, 79
- Коллективные процессы в примесной рекомбинационном излучении прямозонных полупроводников. Ключанов А. А., Семенов Э. А., Федоров В. М. 3, 542
- Температурная зависимость люминесценции арсенида индия и твердых растворов InAsSbP и InGaAs . Айдаралиев М., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Стус Н. М. 4, 592
- Фотолюминесцентные свойства твердых растворов $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$, легированных рением. Андреев В. М., Зимогорова Н. С., Карлина Л. В., Никитин Л. П., Устинов В. М., Васильев А. М. 4, 612
- Фотолюминесценция в пленках $\alpha\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x$: H и $\alpha\text{-Si}_{1-x}\text{N}_x$: H . Бабаев А. А., Терруков Е. И., Жданович Н. С., Мусабекоев Е. 4, 636
- Влияние облучения протонами на люминесценцию арсенида галлия. Глинчук К. Д., Заяц Н. С., Прохорович А. В. 4, 657
- Фотолюминесценция $p\text{-InAs(Mn)}$. Георгицэ Е. И., Постолаки И. Т., Смирнов В. А., Унтила П. Г. 4, 745
- Фотолюминесценция сверхрешеток PbS-EuS . Колесников И. В., Сипатов А. Ю. 6, 954
- Квантово-размерные эффекты в фотолюминесценции сверхрешеток на основе халькогенидов свинца. Колесников И. В., Ковалев А. Н., Сипатов А. Ю.,

Парамонов В. П., Федоренко А. И., Юнович А. Э. 6, 960

12.3. Рекомбинационно-генерационные процессы. Времена жизни носителей

Об одной особенности донора серы в GaP. Бирюлин Ю. Ф., Лагвилава Т. А., Мильвидский М. Г., Писаревская В. А., Соловьева Е. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 6, 1070

Влияние заряженных AD^+ -комплексов на спектр краевой люминесценции. Толпыго К. Б., Штаерман Э. Я. 6, 1121

Влияние легирования индием на люминесценцию монокристаллов арсенида галлия. Анастасьева Н. А., Большева Ю. Н., Освенский В. Б., Степанцова И. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 7, 1259

Спонтанная электролюминесценция в гетеропереходах II типа на основе GaInAsSb/GaSb ($\lambda=2.5$ мкм, $T=300$ К). Андаспаева А. А., Баранов А. Н., Гребенщикова Е. А., Гусейнов А. А., Именков А. Н., Рогачев А. А., Филаретова Г. М., Яковлев Ю. П. 8, 1373

Получение МОС гидридным методом при пониженном давлении и фотолюминесцентные исследования GaAs/AlGaAs квантово-размерных структур. Кузьмин И. А., Машевский А. Г., Строганов Д. Р., Федорова О. М., Явич Б. С. 8, 1420

Влияние концентрации электронов на эффективность возбуждения люминесценции Yb^{3+} в $InP<Yb>$. Захаренков Л. В., Касаткин В. А., Савельев В. П. 8, 1515

Тонкая структура излучения при рекомбинации на комплексных дефектах в теллуриде кадмия. Бабенцов В. Н., Булах В. М., Горбань С. И., Рашковецкий Л. В., Сальков Е. А. 9, 1560

Вертикальный транспорт и фотолюминесценция в сверхрешетках. Ларкин И. А. 9, 1664

Люминесценция арсенида галлия с участием пар атомов переходных металлов и мелких примесей. Быковский В. А., Утенко В. И. 10, 1767

Влияние отношения потоков мышьяка и галлия на люминесценцию арсенида галлия, полученного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Лубышев Д. И., Мигаль В. П., Преображенский В. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 10, 1913

Излучательная рекомбинация в легированном глубокими примесями и облученном германии. Быковский В. А., Голубев Н. Ф., Долгих Н. И. 11, 1981

Квантовый выход люминесценции иттербия в фосфиде индия. Васильев А. Э., Касаткин В. А., Савельев В. П. 11, 2069

Переходы с участием размерно-квантованных подзон в спектре фотолюминесценции δ -легированного GaAs. Васильев А. М., Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. 12, 2133

Рекомбинация носителей заряда в арсениде галлия, содержащем области скопления дефектов. Ломако В. М., Старостин П. Я. 1, 90

Прыжковая генерация носителей заряда в истощенных слоях полупроводников с непрерывным спектром локализованных состояний. Кюрегян А. С. 1, 110

Две модели туннельной излучательной рекомбинации в неупорядоченных полупроводниках. Барановский С. Д., Шкловский Б. И. 1, 146

Рекомбинационные процессы в радиационно облученных фоточувствительных структурах на основе селенида галлия. Абасова А. З., Заитов Ф. А., Любченко А. В., Султанмурадов С. 1, 152

О системе механизмов рекомбинации неравновесных носителей заряда в сильно возбужденных прямозонных полупроводниках.* Лукашевич П. Г., Павловский В. Н., Самойлюкович В. А. 3, 578

Способ определения времени жизни неосновных носителей в полупроводниках.* Городецкий С. М., Литовский И. А. 3, 580

Исследование влияния междырьчного рассеяния на время релаксации энергии дырок в Ge. Рагуотис Р., Сельмистрайтис Г. 4, 709

Оже-рекомбинация в сильно легированном германии. Карпова И. В., Перель В. И., Сыровергин С. М. 5, 826

Диффузионная длина дырок в селениде цинка. Оконечников А. П., Мельник Н. Н. 5, 894

Исследование релаксации энергии и захвата носителей заряда при фотоионизации примесных центров в p -GaAs. Берегулин Е. В., Ярошецкий И. Д. 6, 947

Исследование потерь энергии горячими электронами в фосфиде индия эмиссионным методом. Мусатов А. Л., Коротких В. Л., Филиппов С. Л. 6, 994

Время жизни неравновесных дырок в диодах на основе SiC. Наумов А. В., Санкин В. И. 6, 1009

Определение скорости поверхностной рекомбинации в тонких варизонных структурах. Коваленко В. Ф., Пека Г. П., Токалин О. А., Химичев А. И. 6, 1108

Диффузионная длина в эпитаксиальном поликристаллическом кремнии, полученном вакуумным испарением. Аleshin А. М., Задорожный Н. С., Коваленко В. Ф., Краснов В. А., Сахаров В. А., Сушко Б. И. 6, 1116

О рекомбинационных волнах в условиях эксклюзии. Карпова И. В., Сабликов В. А. 7, 1293

Влияние межзонного перехода на затухание плазменных колебаний в сплавах висмут—сурьма. Степанов Н. П.,

Грабов В. М., Вольф Б. Е. 7, 1312
 Время релаксации импульса 2D-электронов $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ в классическом магнитном поле. Кадушкин В. И., Денисов А. А., Колосова С. В. 10, 1721
 Расчеты вероятностей излучательных переходов и времен жизни в квантово-размерных структурах. Соколова З. Н., Халфин В. Б. 10, 1806
 Рекомбинационные процессы в $p\text{-Mn}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ с $x \approx 0.1$. Беговатов В. Е., Барышев Н. С., Белый Н. Н., Бряцкий М. Н., Горбатюк И. Н. 11, 2074
 Рекомбинационные свойства полупроводниковых сплавов $n\text{-Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$. Мартяхин В. А. 12, 2223

13. Физика контактных явлений

Переходный ток в полупроводнике с барьерным контактом. Бобылев Б. А., Косцов Э. Г. 2, 224
 Длина когерентности в полупроводниковой области контакта сверхпроводник-полупроводник с учетом непараболичности зоны. Гасанова А. Т., Исмаилов И. А., Мамедов Ш. Ф., Мехтиев А. Ш., Тагцев А. Г. 2, 236
 Поляризационная фоточувствительность барьеров электролит- CdGeP_2 . Горячев Д. Н., Рудь Ю. В., Таиров М. А. 2, 312
 К теории туннельно-резонансного инжектора. Долманов И. Н., Рыжий В. И., Толстихин В. И. 3, 499
 Емкостные характеристики барьера на границе Me-XSP . Бордовский Г. А., Каничев М. Р., Любин В. М. 4, 616
 Контактные явления в двумерном электронном газе. Петросян С. Г., Шик А. Я. 6, 1113
 О рекомбинационных волнах в условиях эксклюзии. Карпова И. В., Сабликов В. А. 7, 1293
 О частотных свойствах изотипного контакта к высокоомному полупроводнику. Блохин И. К., Рахубовский А. А., Холоднов В. А. 10, 1747
 Релаксация фотопотенциала кремния в электролите. Беклемышев В. И., Маслов А. П., Махонин И. И., Морозов А. Ф., Петров Ю. Н., Пустовойт В. И. 11, 1943

13.1. Диоды и барьеры Шоттки

Немонотонность вольтамперной зависимости тонкопленочных полупроводниковых структур с барьером Шоттки. Горев Н. Б., Костылев С. А., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т. 2, 357
 О механизме работы диодного стабилизатора тока. Добровольский В. Н., Винославский М. Н., Павлюк С. П., Коломицкий Н. Г. 3, 416
 Резонансные явления в структурах Шоттки при возбуждении «медленных» поверхностных электромагнитных волн. Беля-

ков Л. В., Горячев Д. Н., Румянцев Б. Л., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 3, 461
 Кинетика тока, ограниченного объемным зарядом, в полупроводниковых n^+p-p^+ -структурах. Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б. 3, 478
 Влияние гидростатического давления на характеристики диодов с барьером Шоттки. Скунов В. Д., Цыркин Г. А. 3, 554
 Экспериментальное подтверждение модели туннельных избыточных токов в $p-n$ -переходах на антимоэиде индия. Пасоков В. Ф. 3, 559
 Вольтамперные характеристики контактов Pb-GaAs , подвергнутых лазерному отжигу. Воронков В. П., Вяткин А. П., Иванов Б. В., Куленов С. М., Рухадзе З. А. 3, 562
 Неклассический термоинжекционный ток в карбид-кремниевых $p-n$ -структурах. Аникин М. М., Евстропов В. В., Попов И. В., Растегаев В. Н., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. 4, 647
 Динамика движения рабочей точки на падающей ветви вольтамперной характеристики сплавов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}\langle\text{In}\rangle$. Акимов Б. А., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 5, 899
 Структурная чувствительность кривых фототода в условиях образования столбчатой рентгеновской волны в полупроводнике с $p-n$ -переходом. Ковальчук М. В., Кон В. Г., Лобанович Э. Ф. 6, 1054
 Влияние примеси бора на дрейф вакансий в областях пространственного заряда диодов Шоттки Al-p-Si . Болотов В. В., Стучинский В. А. 7, 1142
 Температурная зависимость напряжения лавинного пробоя $p-n$ -переходов с глубокими уровнями. Режим релаксационной задержки пробоя. Кюрегян А. С., Шлыгин П. Н. 7, 1164
 Модель объемного шума $1/f$ в лавинно-пролетных диодах. Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. 7, 1187
 «Мотговское» плато на вольтамперной характеристике диода Шоттки с гетеропереходом. Константинов О. В., Львова Т. В., Паханов М. М. 7, 1283
 Тепловое излучение прямо смещенного полупроводникового диода. Малютенко В. К., Тесленко Г. И. 8, 1452
 Разновидность неклассического термоинжекционного тока в карбид-кремниевых $p-n$ -структурах. Аникин М. М., Евстропов В. В., Попов И. В., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. 10, 1813
 Формирование профиля концентрации А-, Е-центров в ОПЗ кремниевых диодных структур. Бобрикова О. В., Стась В. Ф., Герасименко Н. Н. 10, 1838
 Поверхностные состояния фосфида индия, определяющие формирование барьера Шоттки. Мусатов А. Л., Гейзер С. В., Коринфский А. Д. 11, 2056
 Влияние микрорельефа поверхности на электрофизические характеристики контакта

металл—полупроводник с барьером Шоттки. Фотоэмиссионные характеристики. Борковская О. Ю., Горбач Т. Я., Дмитриук Н. Л., Мищук О. Н. 12, 2113

13.2 Гетероструктуры

Кинетика фотоотклика и спектры Q -DLTS гетероструктур с изолирующим слоем $Al_{0.3}Ga_{0.7}As$, изготовленных МОС гидридным методом. Поляков В. И., Перов П. И., Ермакова О. Н., Ермаков М. Г., Руковишников А. И., Сергеев В. И. 1, 125

Свойства эпитаксиальных слоев GaAs, выращенных на германиевых подложках. Быковский В. А., Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. 1, 166

Пограничные состояния в зоне проводимости резкого гетероперехода. Кисин М. В. 2, 292

Теория квазибаллистического транспорта электронов в биполярном гетеротранзисторе с сильно легированной субмикронной базой. Константинов О. В., Мезрин О. А., Трошков С. И. 3, 508

Фотоэлектрические свойства $AlGaAs$ — $GaAs$ -гетероструктур с туннельно-тонким «широкозонным окном». Андреев В. М., Воднев А. А., Ларионов В. Р., Прудких Т. А., Румянцев В. Д., Расулов К. Я., Хвостиков В. П. 4, 597

Уровни энергии и волновые функции электронов в потенциальной яме селективно легированных гетероструктур. Каминский В. Э. 4, 662

К теории внутрizonного оптического поглощения в гетероструктурах с квантовыми ямами. Осипов В. В., Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. 5, 809

Особенности эффекта устойчивой фотопроводимости в селективно легированных двойных гетероструктурах $GaAs/n-(Al, Ga)As$. Евтихий В. П., Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. 5, 845

Фотоэлектрическое усиление лавинных гетероструктур с тонким широкозонным слоем. Осипов В. В., Панкратов А. А., Холоднов В. А. 7, 1148

Эффективная температура и релаксация энергии $2D$ -электронов $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$. Кадушкин В. И., Денисов А. А., Сеничкин А. П. 7, 1199

К вопросу о пограничных состояниях в резких гетеропереходах. Райчев О. Э. 7, 1226

«Моттовское» плато на вольтёмкостной характеристике диода Шоттки с гетеропереходом. Константинов О. В., Львова Т. В., Паханов М. М. 7, 1283

Спонтанная электролюминесценция в гетеропереходах II типа на основе $GaInAsSb/GaSb$ ($\lambda=2.5$ мкм, $T=300$ К). Андаспаева А. А., Баранов А. Н., Гребенщикова Е. А., Гусейнов А. А., Именков А. Н., Рогачев А. А., Филаретова Г. М., Яковлев Ю. П. 8, 1373

Механизмы нестационарной фотопроводимости в селективно легированных гетероструктурах $GaAs/n-(Al, Ga)As$. Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. 8, 1382

Определение электрофизических параметров тонких гетероэпитаксиальных слоев в растровом электронном микроскопе (теория). Конников С. Г., Соловьев В. А., Уманский В. Е., Чистяков В. М. 8, 1411

Определение электрофизических параметров тонких гетероэпитаксиальных слоев в растровом электронном микроскопе (эксперимент). Конников С. Г., Салата О. В., Соловьев В. А., Сичицын М. А., Уманский В. Е., Винокуров Д. А. 8, 1416

Получение МОС гидридным методом при пониженном давлении и фотолюминесцентные исследования $GaAs/AlGaAs$ квантоворазмерных структур. Кузьмин И. А., Машевский А. Г., Строганов Д. Р., Федорова О. М., Явич Б. С. 8, 1420

Аномалии низкотемпературной проводимости канала с $2D$ -электронами гетероструктур $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$. Кадушкин В. И., Денисов А. А., Сеничкин А. П. 9, 1702

Время релаксации импульса $2D$ -электронов $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ в классическом магнитном поле. Кадушкин В. И., Денисов А. А., Колосова С. В. 10, 721

Надбарьерный фототок в гетеропереходах $p-Ge/n-GaAs$. Белоусова Т. В., Неизвестный И. Г., Садофьев Ю. Г., Супрун С. П., Шерсткова В. Н., Шумский В. Н. 11, 1955

Влияние хода уровня Ферми на расчет туннельно-рекомбинационного тока в гетеропереходе. Борщак В. А., Васильевский Д. Л. 11, 2076

Напряжения несоответствия в гетероструктуре $Pb_{0.93}Sn_{0.07}Se-PbS_{0.05}Se_{0.95}$. Гайдуков Ю. П., Гаськов А. М., Малинский И. М., Никифоров В. Н., Васильева О. Н. 11, 2098

13.3. Варизонные структуры

Нестационарный фотоэффект в варизонной $m-p-n$ -структуре. I. Распространение импульса неравновесных носителей заряда. Резников Б. И., Царенков Г. В. 5, 849

Определение скорости поверхностной рекомбинации в тонких варизонных структурах. Коваленко В. Ф., Пека Г. П., Токалин О. А., Химичев А. И. 6, 1108

Нестационарный фотоэффект в варизонной $m-p-n$ -структуре. II. ЭДС холостого хода. Резников Б. И., Царенков Г. В. 7, 1235

Исследование градиентных гетероструктур электронно-зондовыми методами. Буянов А. В., Пека Г. П., Ткаченко В. Н., Токалин О. А. 9, 1589

13.4. Многослойные структуры

Теория квазибаллистического транспорта электронов в биполярном гетеротранзи-

- сторе с сильно легированной субмикронной базой. Константинов О. В., Мезрин О. А., Трошков С. И. 3, 508
- Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных арсенид-галлиевых $p^+ \rightarrow n^- \rightarrow p^+ \rightarrow n^-$ -структур. Воронин С. Т., Кравченко А. Ф., Шерстяков А. П., Горбушов К. В. 5, 787
- Электронно-механический резонанс на глубоких центрах в $p^+ \rightarrow p^0 \rightarrow n^- \rightarrow n^0$ -структурах арсенида галлия. Лебедев А. А., Митрохин В. И., Рембеза С. И., Свиридов В. В., Степанова М. Н., Ярославцев Н. П. 5, 897
- «Моттовское» плато на вольтамперной характеристике диода Шоттки с гетеропереходом. Константинов О. В., Львова Т. В., Паханов М. М. 7, 1283
- Нижнекционное очувствление симметричных МПМ структур на основе $CdSe \langle Ag \rangle$ в среднем диапазоне ИК света. Зобов Е. М., Ризаханов М. А. 7, 1291
- Особенности инжекции неосновных носителей заряда в анизотропной ПТДП структуре. Драпак С. И., Катеринчук В. Н., Ковалюк З. Д., Манассон В. А. 8, 1510
- Эффективная модуляция излучения и N -образная ВАХ для фотодиа при электропоглощении света в двойной $p-i-N$ -гетероструктуре. Бутусов Д. М., Гоцадзе Г. Г., Рывкин Б. С. 9, 1604
- Об использовании кремниевых структур типа $M-II-M$ в методе емкости спектровосприимчивости глубоких уровней. Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б., Шокина Е. В. 9, 1613
- К теории плазменных волн в слоистых структурах. Ермолин А. В., Кучма А. Е., Свердлов В. А. 9, 1709
- 13.5. Периодические структуры, сверхрешетки
- Энергетический спектр носителей, описываемых моделью Дирака, в квантовой яме. Дугаев В. К., Петров П. П. 3, 488
- Влияние амплитудной решетки на дифракционную эффективность динамических голограмм в кремнии. Балтрамеюнас Р., Велецкас Д. 3, 517
- Особенности усиления электромагнитных сигналов в квантовых сверхрешетках с высоким уровнем межминизионного туннельного тока.* Орлов Л. К., Романов Ю. А. 3, 578
- Собственные колебания в сверхрешетке, образованной когерентными лучами в многодолинном полупроводнике. Дыкман И. М. 4, 621
- Термоэлектрические свойства сверхрешеток во внешних полях. Шмелев Г. М., Чайковский И. А., Менса С. И. 4, 712
- Исследование оптического усиления в сверхрешетках $GaAs-Al_xGa_{1-x}As$. Балтрамеюнас Р., Вайнерт Х., Геразимас Е., Куокштис Э., Ханнебергер Ф. 5, 792
- Локализованные электронные состояния на дефектах полупроводниковой сверхрешетки. Гашимаде Н. Ф., Ивченко Е. Л., Кособукин В. А. 5, 839
- Фотолюминесценция сверхрешеток $PbS-EuS$. Колесников И. В., Сигатов А. Ю. 6, 954
- Квантово-размерные эффекты в фотолюминесценции сверхрешеток на основе халькогенидов свинца. Колесников И. В., Ковалев А. Н., Сигатов А. Ю., Парамонов В. И., Федоренко А. И., Юпович А. Э. 6, 960
- Электродинамические свойства сверхрешеток $PbTe-Pb_{1-x}Sn_xTe$. Апатская М. В., Сизов Ф. Ф., Тетеркин В. В., Ушанкина Н. Н. 7, 1203
- Зонная структура напряженных (001) сверхрешеток $(InAs)_n(GaAs)_n$. Полигалов Ю. И., Поплавной А. С. 7, 1254
- Об ионизации примесей солитонами в сверхрешетках. Крючков С. В. 7, 1314
- Спектр поглощения структур с квантовыми ямами. Копьев П. С., Решина И. И. 7, 1316
- Энергетическая релаксация и транспорт электронов и дырок в короткопериодических полупроводниковых сверхрешетках. Иванов С. В., Копьев П. С., Некрасов В. Ю., Пахомов А. Г., Трухин В. Н., Ярошецкий И. Д. 9, 1564
- Вертикальный транспорт и фотолюминесценция в сверхрешетках. Ларкин И. А. 9, 1664
- Индукцированные магнитным полем электронные переходы в полупроводниках со сверхрешеткой. Поляновский В. М. 9, 1680
- Флуктуации поперечного тока в легированной сверхрешетке. Кондратьева О. Г., Неустроев Л. Н., Осипов В. В. 10, 1741
- Электронная зонная структура монослойных сверхрешеток (111) из узкозонных полупроводников A^IVB^VI . Канцер В. Г., Малкова Н. М., Тофан В. А. 11, 2006
- Уровни, создаваемые короткодействующим потенциалом дефектов и примесей, в квантовых ямах на основе полупроводника типа A^IVB^VI . Дугаев В. К., Петров П. П. 12, 2238
- 13.6. МДП структуры
- Поверхностная подвижность электронов в МДП структурах из $Cd_xHg_{1-x}Te$ p -типа. Пономаренко В. П., Салмин Е. А., Стафеев В. И., Шиманский И. В. 1, 189
- Отрицательная дифференциальная фотопроводимость в МДП структурах. Манассон В. А., Комиссаров Г. П. 3, 557
- Влияние электронного облучения на характер низкотемпературной проводимости и емкости в кремниевых МДП структурах. Галаев А. А., Выговская Е. А., Маликович М. Д. 5, 916
- Поверхностное рассеяние носителей заряда в инверсионных n -каналах $Si-MOП$

структур. Байрамов М. А., Веденеев А. С., Ждан А. Г., Шамхалова Б. С. 9, 1618

Влияние γ -облучения на генерацию носителей заряда в МДП структурах на основе кремния. Безлюдный С. В., Колесников Н. В., Санин К. В., Суриков И. Н., Хансеев Р. Ю., Якименко А. Н. 10, 1888

Пьезопротивление короткоканальных МДП транзисторов. Кочетов Ю. А., Макаров Е. А., Шадрин В. С. 10, 1904

Влияние тонкого диэлектрического слоя на свойства ПЭВ на границе металл—полупроводник. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Макарова Т. Л., Румянцев Б. Л., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 11, 1966

Туннелирование и поверхностные состояния в контакте Au—InAs p -типа. Кольцов Г. И., Крутенюк Ю. В. 11, 1986

Механизм генерации заряда в МДП структуре. Безлюдный С. В., Карпов В. Г., Колесников Н. В., Якименко А. Н. 11, 2013

Туннельные МДП контакты на основе PbTe, полученные методом химической сборки. Дрозд В. Е., Романычев А. И., Рыков С. А., Рыкова М. А., Ципер Е. В. 11, 2085

Динамика проявлений флуктуационного потенциала и поверхностного рассеяния в кинетических характеристиках инверсионного Si— n -канала. Байрамов М. А., Веденеев А. С., Ждан А. Г. 12, 2122

14. Твердые растворы полупроводников

Подвижность носителей тока в твердых растворах $Ge_{1-x}Se_x$. Шаховцов В. И., Шаховцова С. И., Шварц М. М., Шпинар Л. И., Ясковец И. И. 1, 48

Нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней в твердых растворах: донорный уровень в $GaAs_{1-x}P_x$. Зубков В. И., Пихтин А. Н., Солмонов А. В. 1, 64

Рассеяние поляритонов и локализация экситонов на флуктуациях состава $Zn_xCd_{1-x}Te$. Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Сальков Е. А. 1, 174

Поверхностная подвижность электронов в МДП структурах из $Cd_xHg_{1-x}Te$ p -типа. Пономаренко В. П., Салмин Е. А., Стафеев В. И., Шиманский И. В. 1, 189

Край оптического поглощения и деформации эпитаксиальных слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As$. Абдуллаев М. А., Гореленок А. Т., Кохановский С. И., Макушенко Ю. М., Пуляевский Д. В., Сейсян Р. П., Штенгель К. Э. 2, 201

Электронное строение валентной зоны твердых растворов $Al_yGa_{1-y}As$ и $GaAs_{1-x}P_x$ по данным рентгеновской спектроскопии. Терехов В. А., Кашкаров В. М., Домашевская Э. П., Арсентьев Н. Н., Иванова Т. М. 2, 268

Допустимые значения параметров уровня собственных дефектов в твердых растворах свинец—олово—селен. Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. Е. 2, 382

Магнитные и электрические свойства $Hg_{1-x}Eu_xTe$ и $Hg_{1-x}Eu_xSe$. Крылов К. Р., Пономарев А. И., Цидильковский И. М., Гавалешко Н. П., Хомяк В. В. 3, 429

Высокочастотная проводимость n - $Cd_xHg_{1-x}Te$ вблизи перехода металл—диэлектрик. Аронзон Б. А., Копылов А. В., Мейлихов Е. Э. 3, 471

Реакции центров золота с отрицательной корреляционной энергией в твердых растворах Si—Ge. Атабаев И. Г., Баграев Н. Т., Машков В. А., Саидов М. С., Сирожов У., Юсупов А. 3, 525

Влияние дефектов структуры на интенсивность $1/f$ -шума в n - $Cd_xHg_{1-x}Te$. Бахши И. С., Гринь В. Ф., Карачевцева Л. А., Кодаляшвили М. З., Сальков Е. А., Хижиак Б. И. 3, 571

Температурная зависимость люминесценции арсенида индия и твердых растворов InAsSbP и InGaAs. Айдаралиев М., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Стус Н. М. 4, 592

Фотолюминесцентные свойства твердых растворов $In_{0.53}Ga_{0.47}As$, легированных рением. Андреев В. М., Зимогорова Н. С., Карлина Л. Б., Никитин Л. П., Устинов В. М., Васильев А. М. 4, 612

Влияние эффективного параметра рассеяния на массу плотности состояний и подвижность в твердых растворах на основе халькогенидов висмута и сурьмы. Кутасов В. А., Лукьянова Л. Н. 4, 652

Проводимость сплавов $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ (In) при комбинированном воздействии электрического и магнитного полей. Акимов Б. А., Никорич А. В., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 4, 668

Флуктуации два зоны проводимости в твердых растворах свинец—олово—селен. Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. В. 4, 742

Край собственного поглощения $Al_xGa_{1-x}As_{1-y}P$. Кузнецов В. В., Разбегаев В. Н., Саид Эль-Гизири. 5, 880

Исследование зонной структуры твердых растворов $In_{1-x}Ga_xP$ с использованием фотоэлектрического метода. Крутоголов Ю. К., Довженко С. В., Диордиев С. А., Крутоголова Л. И., Кунакин Ю. И., Рыжих С. А. 5, 887

Динамика движения рабочей точки на падающей ветви вольтамперной характеристики сплавов $Pb_{1-x}Sn_xTe$ (In). Акимов Б. А., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 5, 899

Диэлектрические свойства $Pb_{1-x}Sn_xSe$ (Cd, Zn). Прозоровский В. Д., Решидова И. Ю., Таряник Н. В., Браташевский Ю. А. 5, 901

Электрические и оптические свойства полупроводниковых твердых растворов $Hg_{1-x-y}Cd_xMn_ySe$. Гавалешко

Н. Н., Кривень С. И., Мазур Ю. И., Паранчич С. Ю., Сизов Ф. Ф. 6, 943

Переход металл—диэлектрик в твердых растворах $Pb_{1-x}Mn_xTe(In)$. Акимов Б. А., Никорич А. В., Рябова Л. И., Широкова Н. А. 6, 1019

Об аномалиях электрофизических свойств эпитаксиальных слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As$ их природе. Виноградова Г. И., Гогадзе Д. Т., Долгинов А. М., Малькова Н. В., Мильвидский М. Г., Соловьева Е. В. 7, 1177

Электрофизические свойства сверхрешеток $PbTe-Pb_{1-x}Sn_xTe$. Апатская М. В., Сизов Ф. Ф., Тетеркин В. В., Ушанкина Н. Н. 7, 1203

Электрические свойства имплантированных He^+ , Cu^+ , Ag^+ и термически отожженных кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. Ибрагимова М. И., Барышев Н. С., Хайбуллин И. Б., Ахмедова Ф. И., Фадеева А. П. 7, 1249

Фотоэлектрические и шумовые свойства пластически деформированных монокристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. Адрухив М. Г., Вирт И. С., Цюцюра Д. И., Шуптар Д. Д., Шкумбатюк П. С. 7, 1263

Фотопроводимость эпитаксиальных слоев $n-Hg_{1-x}Mn_xTe$. Назаренкова Т. И., Сальков Е. А., Сочинский Н. В. 7, 1309

Изменение свойств приповерхностных слоев кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ под воздействием электронного пучка. Панин Г. Н., Якимов Е. Б. 8, 1351

Электропроводность и эффект Холла узкощелевых полупроводников $PbSe\langle Mn \rangle$ и $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Se\langle Mn \rangle$. Мисюра И. В. 8, 1475

Электронная структура собственных дефектов кристаллической решетки $PbSe$ и $Pb_{1-x}Sn_xSe_x$. Бродовой А. В., Лашкарев Г. В., Кучеренко И. В. 8, 1506

Переменная валентность в твердом растворе $Pb_{1-x}Sn_xSe$ ($x=0.15$), легированном натрием. Дегтярев Ю. А., Константинов П. П., Майлина Х. Р., Прокофьева Л. В. 9, 1576

Легирование слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As$ самарием. Воробьева В. В., Егорова М. В., Крещук А. М., Новиков С. В., Савельев И. Г. 9, 1699

Классификация доноров и акцепторов в тройных и четверных растворах системы $InGaAsP$ с помощью атомарного водорода. Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Шепекин Г. В. 9, 1711

О фазовом переходе порядок—беспорядок в катионной подрешетке соединения $ZnGa_2Se_4$. Тигпяну И. М., Ураски В. В., Фулга В. Н. 10, 1725

Гальваномагнитные явления в сплавах $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ с малой концентрацией In (0.1 ат%) вблизи бесщелевого состояния. Кучеренко И. В., Каширская Л. М., Мёллманн К. П., Ицкевич Е. С. 10, 1784

Светоизлучающие приборы с длиной волны 520÷550 нм на основе $Ga_{1-x}Al_xP$. Джав

хуташвили Т. В., Михелашвили В. М., Сагинури М. И., Скакут Т. А., Чиковани Р. И. 12, 2198

15. Бесщелевые полупроводники и полупроводники с узкой запрещенной зоной

Влияние одноосной деформации на энергетический спектр и гальваномагнитные явления в бесщелевом $p-HgMnTe$. Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э., Гавалешко Н. П., Фрасуняк В. М. 1, 117

Примесные состояния теллура в сульфиде свинца по данным ИК поглощения. Вейс А. Н., Круницкая Р. Ю. 1, 185

Поверхностная подвижность электронов в МДП структурах из $Cd_xHg_{1-x}Te$ p -типа. Пономаренко В. П., Салмин Е. А., Стафеев В. И., Шиманский И. В. 1, 189

Термоэдс $p-HgMnTe$ в магнитном поле. Горюдилов Н. А., Доманская Л. И., Нейфельд Э. А., Шелушигина Н. Г. 2, 316

Электрофизические свойства пленок $PbTe$, облученных ионами аргона. Аброян И. А., Алнев В. З., Имамкулиев С. Д., Казьмин С. А., Кайданов В. И., Касаманли Г. Д. 2, 352

Допустимые значения параметров уровня собственных дефектов в твердых растворах свинец—олово—селен. Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свиатов А. Е. 2, 382

Магнитные и электрические свойства $Hg_{1-x}Eu_xTe$ и $Hg_{1-x}Eu_xSe$. Крылов К. Р., Пономарев А. И., Цидильковский И. М., Гавалешко Н. П., Хомяк В. В. 3, 429

Высокочастотная проводимость $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ вблизи перехода металл—диэлектрик. Аронзон Б. А., Копылов А. В., Мейлихов Е. З. 3, 471

Экспериментальное подтверждение модели туннельных избыточных токов в p - n -переходах на антимиониде индия. Пасеков В. Ф. 3, 559

Влияние дефектов структуры на интенсивность $1/f$ -шума в $n-Cd_xHg_{1-x}Te$. Баши И. С., Гринь В. Ф., Карачевцев Л. А., Кодашвили М. З., Сальков Е. А., Хижняк Б. И. 3, 571

Горячие носители в узкощелевых полупроводниках в сильном электрическом поле. Генкин Г. М., Окомельков А. В. 4, 630

Влияние эффективного параметра рассеяния на массу плотности состояний и подвижность в твердых растворах на основе халькогенидов висмута и сурьмы. Кутасов В. А., Лукьянова Л. Н. 4, 652

Проводимость сплавов $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In)$ при комбинированном воздействии электрического и магнитного полей. Акимов Б. А., Никорич А. В., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 4, 668

Переход металл—диэлектрик в бесщелевых полупроводниках $p-Hg_{1-x}Cd_xTe$ с $x \approx 0.15$.

- Давыдов А. Б., Штрапенни Г. Л. 4, 715
- Магнитная восприимчивость при структурном фазовом переходе в узкощелевых полупроводниках $Pb_{1-x}Sn_xSe$. Золотухина В. В., Мисюра И. В. 4, 728
- Флуктуации дна зоны проводимости в твердых растворах свинец—олово—селен. Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. Е. 4, 742
- Кинетические явления в одноосном деформированном $p-Hg_{1-x}Cd_xTe$ с $\epsilon_y > 0$. Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э., Инишева О. В. 5, 796
- Особенности поведения примеси хрома в теллуриде свинца. Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В., Колесник С. П., Вертелецкий П. В. 5, 874
- Динамика движения рабочей точки на падающей ветви вольтамперной характеристики сплавов $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. Акимов Б. А., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. 5, 899
- Диэлектрические свойства $Pb_{1-x}Sn_xSe(Cd, Zn)$. Прозоровский В. Д., Решидова И. Ю., Таряник Н. В., Браташевский Ю. А. 5, 901
- Электрические и оптические свойства полумангнитных твердых растворов $Hg_{1-x-y}Cd_xMn_ySe$. Гавалешко Н. Н., Кривень С. И., Мазур Ю. И., Паранчич С. Ю., Сизов Ф. Ф. 6, 943
- Влияние глубоких уровней на свойства легированного $PbTe$. Ковалев А. Н., Фоломин П. И., Золотов С. И. 6, 968
- Образование радиационных дефектов в пленках $PbSe$ при облучении α -частицами. Фрейк Д. М., Салий Я. П., Межиловская Л. И., Собкович Р. И., Школьный А. К., Огородник Я. В. 6, 1015
- Переход металл—диэлектрик в твердых растворах $Pb_{1-x}Mn_xTe(In)$. Акимов Б. А., Никорич А. В., Рябова Л. И., Широкова Н. А. 6, 1019
- Состояние Eu и Mn в теллуриде свинца. Громовой Ю. С., Дарчук С. Д., Коновалов В. Н., Лакеевков В. М., Пляцко С. В., Сизов Ф. Ф. 6, 1025
- Гальваномагнитные явления в кристаллах $n-Hg_{1-x-y}Cd_xMn_yTe$ и $n-Hg_{1-y}Mn_yTe$ с $\epsilon_y > 0$. Глузман Н. Г., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Боднарук О. А., Горбатюк И. Н., Раренко И. М. 6, 1032
- Электрофизические свойства сверхрешеток $PbTe-Pb_{1-x}Sn_xTe$. Апатская М. В., Сизов Ф. Ф., Тетеркин В. В., Ушанкина Н. Н. 7, 1203
- Примесь индия в селениде свинца — центр с отрицательной корреляционной энергией. Вейс А. Н., Прокофьева Л. В. 7, 1230
- Электрические свойства имплантированных He^+ , Cu^+ , Ag^+ и термически отожженных кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. Ибрагимова М. И., Барышев Н. С., Хайбуллин П. Б., Ахмедова Ф. И., Фадеева А. П. 7, 1249
- Фотоэлектрические и шумовые свойства пластических деформированных монокристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. Андрухив М. Г., Вирт И. С., Цюцюра Д. И., Шуптар Д. Д., Шкумбатьюк П. С. 7, 1263
- Измерение концентрации плазмы при поперечном пробое в $n-InSb$. Ботте В. А., Владимиров В. В., Горшков В. Н., Липтуга А. И., Малютенко В. К. 7, 1303
- Фотопроводимость эпитаксиальных слоев $n-Hg_{1-x}Mn_xTe$. Назаренкова Т. И., Сальков Е. А., Сочинский Н. В. 7, 1309
- Влияние межзонного перехода на затухание плазменных колебаний в сплавах висмут—сурьма. Стенанов Н. П., Грабов В. М., Вольф Б. Е. 7, 1312
- Изменение свойств приповерхностных слоев кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ под воздействием электронного лучка. Панин Г. Н., Якимов Е. Б. 8, 1351
- Особенности электрофизических и фотоэлектрических свойств монокристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутых лазерному облучению. Вирт И. С., Любченко А. А., Мозоль П. Е., Гнатюк В. А. 8, 1386
- Глубокие центры в монокристаллах и тонких слоях антимида индия. Волков В. В., Падалко А. Г., Белотелов С. В., Божко В. В., Лазарев В. Б. 8, 1400
- Зоны и оптические спектры селенида висмута. Соболев В. В., Крамарь В. М., Козлова С. Г., Темчук Г. И. 8, 1430
- Электропроводность и эффект Холла узкощелевых полупроводников $PbSe(Mn)$ и $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Se(Mn)$. Мисюра И. В. 8, 1475
- Электронная структура собственных дефектов кристаллической решетки $PbSe$ и $Pb_{1-x}Sn_xSe_x$. Бродовой А. В., Лашкарев Г. В., Кучеренко И. В. 8, 1506
- Электрофизические свойства суперионного $Cu_{2-x}Se$. Коржув М. А., Банкина В. Ф., Грузинов Б. В., Бушмарина Г. С. 9, 1545
- Переменная валентность в твердом растворе $Pb_{1-x}Sn_xSe$ ($x=0.15$), легированном натрием. Дегтярев Ю. А., Константинов П. П., Майлина Х. Р., Прокофьева Л. В. 9, 1576
- Магнитная восприимчивость теллурида свинца, легированного гадолинием. Заячук Д. М., Иванчук Д. Д., Иванчук Р. Д., Микитюк В. И., Старик П. М. 9, 1654
- О возможности появления хаотических решений в модели узкозонного полупроводника в режиме ударной ионизации. Безручко Б. П., Ерастова Е. Н. 9, 1707
- Нелинейное поглощение света в $Cd_xHg_{1-x}Te$. Средин В. Г., Укроженко В. М. 10, 1762
- Гальваномагнитные явления в сплавах $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ с малой концентрацией In (0.1 ат%) вблизи бесщелевого состояния.

Кучеренко И. В., Каширская Л. М., Мёллманн К. П., Ицкевич Е. С. 10, 1784

М. М., Несредин Ф. С., Серегин П. П. 9, 1552

Влияние высокого гидростатического давления на экситонный спектр микрокристаллов CdS в стекле. Екимов А. И., Крейнгольд Ф. И., Куликин Б. С. 9, 1556

16. Аморфные стеклообразные и жидкие полупроводники

Туннельные состояния в аморфном кремнии. Соловьев В. Н., Хрисанов В. А. 1, 68

Фотогистимулированная трансформация внутризонных состояний халькогенидных стеклообразных полупроводников. Микла В. И., Мателешко А. В., Семак Д. Г., Левкулич А. Р. 1, 131

Две модели туннельной излучательной рекомбинации в неупорядоченных полупроводниках. Барановский С. Д., Шкловский Б. И. 1, 146

Увеличение дрейфовой подвижности носителей заряда в халькогенидных стеклообразных полупроводниках при легировании бромом. Исаев А. И., Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Ятлинко И. И. 1, 181

Микро неоднородности и примесная проводимость в пленках стеклообразного As_2Se_3 , легированного Bi. Калмыкова Н. П., Мазец Т. Ф., Сморгонская Э. А., Цэндин К. Д. 2, 297

Токовая деградация гетероструктур на основе α -Si:H. Ендриховский С. А., Ройзин Я. О., Свиридов В. Н., Цыбесков Л. В. 3, 444

Структурная сетка, уровень Ферми и плотность состояний аморфного кремния. Голикова О. А., Домашневская Э. П., Казанин М. М., Кудоярова В. Х., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Терехов В. А., Тростянский С. Н. 3, 450

Аномальный эффект Стеблера—Вронского в легированных бором пленках α -Si:H. Курова И. А., Мочалова Д. А., Лупачева А. Н. 3, 573

Электрические и фотоэлектрические свойства пленок стеклообразного сульфида мышьяка, фотогерметизированного цинком. Колобов А. В., Любин В. М., Тагирджанов М. А. 4, 601

О структурных изменениях в стеклообразном $AsGeSe$, облученном большими дозами нейтронов. Копорова Л. Ф., Жданович Н. С., Дидик В. А., Прудников И. М. 4, 706

Частотная зависимость ширины линии ЭПР в аморфном кремнии в интервале 9—130 ГГц. Бугай А. А., Зарицкий И. М., Лукин С. Н., Неймарк Е. И., Кабдин Н. Н. 5, 872

О размерах упорядоченных областей в некристаллическом гидрогенизированном кремнии. Сванбаев Е. А., Таурбаев Т. И. 5, 903

Влияние состава на электронную структуру аморфного As_xSe_{1-x} . Шунин Ю. Н., Шварц К. К. 6, 1049

Примесные центры диспропорции в аморфном гидрогенизированном кремнии. Регель А. Р., Абдуматапов У. Ж., Васильев В. А., Мездрогина

М. М., Несредин Ф. С., Серегин П. П. 9, 1552

Эффект псевдолегирования аморфного кремния. Голикова О. А., Казанин М. М., Кудоярова В. Х., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Бабаходжаев У. С. 10, 1737

Дефектообразование в α -Si:H при дегидрогенизации и оптической деградации. Казанский А. Г., Миличевич Е. П. 11, 2027

Кинетика эффекта Стеблера—Вронского в нелегированных пленках α -Si:H. Курова И. А., Мелешко Н. В., Ормонт Н. Н., Лупачева А. Н. 11, 2030

Влияние трехцентровых связей на электронные свойства аморфного гидрогенизированного кремния. Голикова О. А., Грехов А. М., Сальков Т. Е. 11, 2060

17. Физика двумерных полупроводниковых систем

Квантовые поправки к проводимости в полупроводниках с двумерным и трехмерным электронным газом. Эксперимент (обзор). Полянская Т. А., Шмарцев Ю. В. 1, 3

Пограничные состояния в зоне проводимости резкого гетероперехода. Кисин М. В. 2, 292

Емкость приповерхностных слоев в квантовых полупроводниках в условиях размерного и магнитного квантования. Раданцев В. Ф., Дерябина Т. И., Завьялов В. В., Зверев Л. П., Кулаев Г. И., Хомутова С. С. 2, 346

Новый тип осцилляций кинетических коэффициентов в квантовых структурах. Япильин И. И., Каригин В. В. 3, 552

Уровни энергии и волновые функции электронов в потенциальной яме селективно легированных гетероструктур. Каминский В. Э. 4, 662

К теории внутризонного оптического поглощения в гетероструктурах с квантовыми ямами. Осипов В. В., Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. 5, 809

Влияние деформации на энергетический спектр валеитной зоны в двумерных полупроводниковых системах. Кибис О. В. 5, 820

Контактные явления в двумерном электронном газе. Петросян С. Г., Шик А. Я. 6, 1113

Эффективная температура и релаксация энергии 2D-электронов n - $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$. Кадушкин В. И., Денисов А. А., Сеичкин А. П. 7, 1199

Спектр поглощения структур с квантовыми ямами. Копьев П. С., Решина И. И. 7, 1316

Влияние неоднородности упругой среды на фононный механизм релаксации двумер-

ных носителей заряда. В артаиян
А. Л., Киракосян А. А. 10, 1851

17.1. Физика поверхности

- Деформация поверхности полупроводника при локальном освещении. Василий А. Н., Сабликов В. А. 1, 33
- Методика и результаты исследования кинетики поверхностной ЭДС в GaAs. Ершова Т. П., Ершов С. Г., Жушков В. Е., Кораблев В. В., Тюкин В. Ю. 2, 323
- Резонансные явления в структурах Шоттки при возбуждении «медленных» поверхностных электромагнитных волн. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Румянцев Б. Л., Среседа О. М., Ярошецкий И. Д. 3, 461
- Влияние поверхностных явлений на фотоэлектрические свойства $CdCr_2Se_4$. Абдуллаев А. А., Гаджиев А. З. 5, 876
- Резонансное взаимодействие поверхностных поляритонов в плоском слое магнитоактивной полупроводниковой плазмы.* Белецкий Н. Н., Глухов О. В. 7, 1319
- Запаздывающие структурные изменения в полупроводниках, стимулированные магнитным полем. Давыдов В. Н., Лоскутова Е. А., Найденов Е. П. 9, 1596
- Теория формирования эмиссионного потока Γ -электронов из полупроводника с отрицательным электронным средством. Либенсон Б. И. 11, 1927
- Очувствление полупроводников приповерхностным полем, возникающим при контакте с электролитом. Арутюнян В. М., Варданян С. Х., Маргарян А. Л. 11, 2062

17.2. Физика пленок инверсионных и эпитаксиальных слоев

- Свойства эпитаксиальных слоев GaAs, выращенных на германиевых подложках. Быковский В. А., Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. 1, 166
- Немонотонные вольтамперные зависимости тонкопленочных полупроводниковых структур с барьером Шоттки. Горев Н. Б., Костылев С. А., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т. 2, 357
- Аномальное поведение загущения акустоэда в эпитаксиальных слоях арсенида галлия. Лубяная М. Д., Марончук И. Е., Юцис А. И. 2, 364
- Линейная по току энергетическая неоднородность квазичастиц в полупроводниковых слоях. Гредескул Т. С. 3, 568
- Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных арсенид-галлиевых $p^+-\nu-\pi-n^+$ структур. Воронин С. Т., Кравченко А. Ф., Шерстяков А. П., Горбушов К. В. 5, 787
- Определение скорости поверхностной рекомбинации в тонких варизонных структурах. Коваленко В. Ф., Пека Г. П., Токалин О. А., Химичев А. И. 6, 1108
- Фотоэлектрическое усиление лавинных ге-

тероструктур с тонким широкозонным слоем. Осипов В. В., Панкратов А. А., Холоднов В. А. 7, 1148

- О гальваномагнитных явлениях в макроскопически неоднородных пленках вблизи порога протекания в наклонном магнитном поле. Морозовский А. Е., Снарский А. А. 7, 1220
- Эволюция флукуационного потенциала при обеднении канала полевого GaAs-транзистора. Орлов А. О., Савченко А. К., Шкловский Б. И. 8, 1334
- Изменение свойств приповерхностных слоев кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ под воздействием электронного пучка. Панин Г. Н., Якимов Е. Б. 8, 1351
- Расположение инжектированной электроннодырочной плазмы высокой плотности в пленках арсенида галлия. Ващенко В. А., Кернер Б. С., Осипов В. В., Сянкевич В. Ф. 8, 1378
- Определение электрофизических параметров тонких гетерозипитаксиальных слоев в растворе электронном микроскопе (теория). Конников С. Г., Соловьев В. А., Уманский В. Е., Чистяков В. М. 8, 1411
- Определение электрофизических параметров тонких гетерозипитаксиальных слоев в растворе электронном микроскопе (эксперимент). Конников С. Г., Салата О. В., Соловьев В. А., Синицын М. А., Уманский В. Е., Винокуров Д. А. 8, 1416
- Поверхностное рассеяние носителей заряда в инверсионных λ -каналах $iSi-MOP$ структур. Байрамов М. А., Веденеев А. С., Ждан А. Г., Щамхалова Б. С. 9, 1618
- Эффект локализации в инверсионном слое на поверхности кремния. Абрамов В. В., Божко А. Д., Кульбачинский В. А., Чудинов С. М. 9, 1704
- О захвате электрона в приповерхностную энергетическую яму полупроводника. Дмитриев С. Г. 10, 1845
- Влияние импульсного лазерного облучения на профиль подвижности и проводимости эпитаксиальных слоев GaAs. Гусakov Г. М., Кодратова Т. Н., Капский А. С., Ларюшин А. И. 10, 1864
- Управляемый быстродействующий переключатель на основе тонких пленок арсенида галлия. Ващенко В. А., Сянкевич В. Ф. 10, 1902

18. Применение полупроводников, полупроводниковые приборы

- Фиолетовый SiC-4H-светодиод. Дмитриев В. А., Коган Л. М., Морозенко Я. В., Царенков Б. В., Челноков В. Е., Черенков А. Е. 1, 39
- Фотопрямик УФ излучения на базе пленки $Zn_xCd_{1-x}S$. Книгин П. И., Мирсататов Ш. А., Розиков Х. 2, 356
- Рентгеночувствительность моноселенида галлия. Арутюнян В. М., Димаксян М. Л., Элбакян В. Л., Григорян Г. Е. 3, 505

Теория квазibalлистического транспорта электронов в bipolarном гетеротранзисторе с сильно легированной субмикронной базой. Константинов О. В., Мезрин О. А., Трошков С. И. 3, 508

К теории вертикального ЛСР фоторезистора. Кондратьева О. Г., Неустров Л. Н., Осипов В. В. 3, 536

Перестройка спектра излучения светодиода магнитным полем. Викулин И. М., Ирха В. И., Коробицын Б. В. 6, 1006

Поляризационные характеристики излучения РОС лазеров с деформированным активным слоем. Аврутин Е. А., Алексеев М. А., Кучинский В. И., Лазутка А. С. 7, 1207

Выпрямление переменного тока и генерация четных гармоник однородными полупроводниками с антисимметричной монотонной ВАХ. Бумялене С., Ласене Г., Пирагас К. 8, 1479

Полевые фототранзисторы с $p-n$ -переходом на основе $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$. Абрамян Ю. А., Папазян Р. З. 8, 1486

Управляемый быстродействующий переключатель на основе тонких пленок арсенида галлия. Ващенко В. А., Синкевич В. Ф. 10, 1902

Об оптимизации концентрации носителей в полупроводниковых термоэлементах. Жукова Н. М., Кашин А. П., Максимов М. З., Марченко О. В. 10, 1908

19. Экспериментальные методы

Методика и результаты исследования кинетики поверхностной ЭДС в GaAs. Ершова Т. П., Ершов С. Г., Жуков В. Е., Кораблев В. В., Тюкин В. Ю. 2, 323

Сравнение параметров глубоких центров в высокоомных полупроводниках при измерении методом фотоэлектрической релаксационной спектроскопии в вариантах температурного и частотного сканирования. Омельяновский Э. М., Поляков А. Я., Тишкин М. В. 4, 725

Об использовании кремниевых структур типа М—П—М в методе емкостной спектроскопии глубоких уровней. Ермич В. К., Иванов А. М., Строган Н. Б., Шокина Е. В. 9, 1613

Емкостная модуляционная спектроскопия глубоких уровней в полупроводниках. Бобылев Б. А., Овсяк В. Н., Севастьянов С. Е., Усик В. И. 11, 1932

20. Из новых книг, поступивших в Редакцию

Новые книги по полупроводникам. Козуб В. И. 2, 386; 5, 925; 6, 1123; 9, 1716; 11, 2101